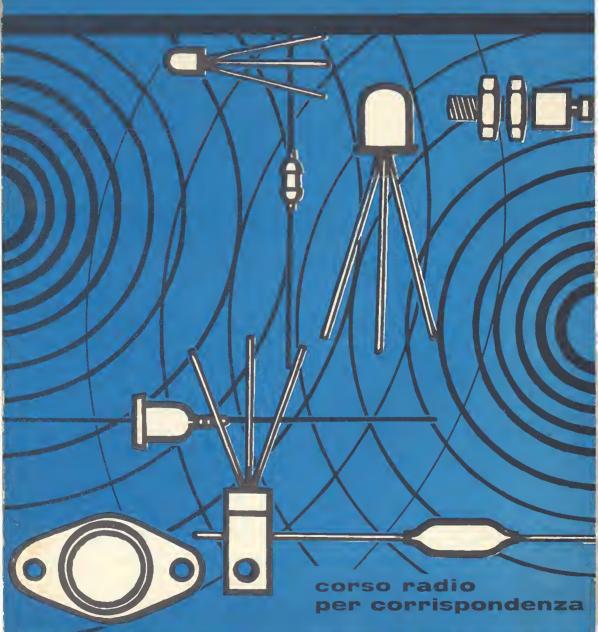
# dati transistori



Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5 - Torino



(41 RS'.

#### PREMESSA

Il presente prontuario riassume i dati tecnici più importanti che caratterizzano il maggior numero possibile dei transistori di tipo europeo, usati particolarmente in campo radio e TV.

Ciò allo scopo di fornire al tecnico riparatore ed a chi si dedica alla realizzazione di apparecchiature sperimentali una guida utile e di facile consultazione per l'identificazione delle principali caratteristiche elettriche e meccaniche dei transistori di tipo più corrente.

I dati raccolti in questo prontuario hanno naturalmente scopo essenzialmente di orientamento.

Coloro che, dedicandosi alla progettazione di apparecchiature, necessitino di informazioni tecniche più dettagliate, potranno richiedere i manuali editi dalle case costruttrici dei semiconduttori.

## 1. - ELENCO E DEFINIZIONI DEI SIMBOLI DEL PRESENTE PRONTUARIO

f : frequenza

fβ : frequenza di taglio del guadagno di corrente con uscita in corto-

circuito (montaggio ad emettitore comune)

f<sub>T</sub> : frequenza di transizione G<sub>D</sub> : guadagno di potenza

G<sub>tr</sub> : guadagno di trasduzione di potenza G<sub>UM</sub> : guadagno di potenza unilateralizzato

hFE : guadagno statico di corrente (emettitore comune)

I<sub>C</sub> : corrente di collettore P : potenza dissipata

R<sub>BE</sub>: resistenza esterna base-emettitore

Rtha : resistenza termica fra la giunzione e l'ambiente (transistore in aria

libera)

Rthc : resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore

Ta : temperatura ambiente

T<sub>C</sub> : temperatura del contenitore
 T<sub>i</sub> : temperatura della giunzione

toff : tempo di commutazione in apertura ton : tempo di commutazione in chiusura

V<sub>CBO</sub>: tensione collettore-base (emettitore aperto)

V<sub>CE</sub>: tensione collettore-emettitore

V<sub>CEO</sub>: tensione collettore-emettitore (base aperta)

V<sub>CER</sub> : tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore chiusa

su un dato resistore RBE)

V<sub>CES</sub> : tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore in corto-

circuito)

V<sub>CEX</sub>: tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore polariz-

zata in senso inverso)

y fe : ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon-

taggio ad emettitore comune)

yfb : ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon-

taggio a base comune)

β : guadagno di corrente dinamico (uscita in cortocircuito; montaggio

ad emettitore comune).

#### 2. - ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE

alim. alimentazione amplificatore ampl. commut. = commutazione compl. complementare contenitore cont. conv. convertitore diss. dissipatore orizz. orizzontale oscill. oscillatore

preampl. = preamplificatore sincr. = sincronizzazione

vert. = verticale.

#### 3. - COME CONSULTARE IL PRONTUARIO

Al fine di consentire una ricerca agevole e rapida, i transistori sono stati riportati seguendo un ordine alfabetico.

Per ciascun transistore sono riportati i dati più importanti, ripartiti sostanzialmente in cinque colonne; nella testata orizzontale in alto si trova, incominciando da sinistra:

- 1) la sigla del transistore;
- 2) la struttura, ossia se è PNP o NPN e, immediatamente sotto, il tipo di contenitore: le connessioni relative sono riportate nelle ultime pagine del Prontuario (Dati Transistori 2):
- 3) l'applicazione tipica per la quale è stato particolarmente studiato (per ragioni di spazio si sono adottate le numerose abbreviazioni sopra specificate):
- 4) i valori massimi assoluti:
- 5) i dati elettrici caratteristici.

Tutte le grandezze sono indicate con le rispettive unità di misura,

ossia:

V = volt kHz = chilohertz
A = ampère MHz = megahertz
mA = milliampère mS = millisiemens
W = watt ns = nanosecondi
°C = gradi centigradi μs = microsecondi

E' bene fare subito una distinzione fra i valori massimi assoluti e le caratteristiche elettriche.

I valori massimi assoluti sono valori limite superati i quali il semiconduttore può danneggiarsi in modo permanente.

Questi limiti dipendono dalle caratteristiche proprie del semiconduttore e vengono quindi stabiliti dal costruttore.

Trattandosi di valori massimi assoluti, devono essere considerati come le estreme possibilità del dispositivo. Le condizioni normali di progetto devono rimanere molto al di sotto di questi valori, che non devono neanche essere raggiunti durante le peggiori condizioni di funzionamento che si possano presentare.

Le caratteristiche elettriche, al contrario, mettono in risalto i parametri più importanti del semiconduttore ed esprimono una proprietà tipica, in una specifica condizione di misura, per la quale il semiconduttore consente prestazioni ripetibili.

Dopo queste precisazioni, possiamo ora esaminare il significato e l'esatta interpretazione dei dati riportati.

## 4. · VALORI MASSIMI DI TENSIONE E DI CORRENTE

Sono riportati i valori delle tensioni inverse di rottura applicate alle giunzioni collettore-base e collettore-emettitore. Il valore massimo di tensione V<sub>CBO</sub> corrisponde alla tensione inversa di rottura della giunzione collettore-base (con emettitore aperto).

La tensione di rottura della giunzione collettore-emettitore interessa invece due giunzioni: la giunzione collettore-base, polarizzata sempre in senso inverso, e la giunzione emettitore-base che al contrario può essere aperta, chiusa su un determinato resistore R<sub>BE</sub>, chiusa in cortocircuito, oppure polarizzata in senso inverso con una determinata tensione.

A queste quattro condizioni corrispondono tensioni di rottura di valore progressivamente crescente, indicate rispettivamente con i simboli  $V_{\text{CEO}}$ ;  $V_{\text{CER}}$ :  $V_{\text{CES}}$ :  $V_{\text{CEN}}$ .

La corrente di collettore l<sub>C</sub> indicata rappresenta il valore massimo, da non superare, per evitare di danneggiare il transistore.

AVVERTENZA: tutti i valori massimi di tensione e di corrente riportati sul presente prontuario sono espressi solo numericamente, ossia essi si intendono, ovviamente, negativi per i transistori PNP e positivi per i transistori NPN.

#### 5. - VALORI MASSIMI DI POTENZA E DI TEMPERATURA

Ciascun transistore è caratterizzato da una temperatura di giunzione massima T<sub>jmax</sub>, superata la quale esso si danneggia.

La temperatura di giunzione Tj di un transistore dipende da tre varia- bili:

la temperatura ambiente T<sub>a</sub> la dissipazione di collettore P la resistenza termica R<sub>tha</sub>

secondo la relazione

$$T_j = T_a + R_{tha} \cdot P.$$

Esaminiamo brevemente il significato di queste tre grandezze.

LSTT

La temperatura ambiente  $T_a$  è la temperatura dell'ambiente in cui si trova il transistore, la quale può essere anche relativamente alta a causa del calore prodotto da resistori o transistori di potenza che si trovino nelle immediate vicinanze del transistore considerato.

La potenza P è quella dissipata sul collettore: per un amplificatore in classe A, è data da:

$$P = V_{CE} \cdot I_{C}$$

dove

V<sub>CE</sub> è la tensione continua collettore-emettitore;

I<sub>C</sub> è la corrente continua di collettore, nelle normali condizioni di funzionamento.

Come accade per qualsiasi resistore, l'energia corrispondente alla potenza P dissipata dal transistore viene trasformata, per effetto Joule, in energia termica. Ciò determina un aumento della temperatura di giunzione, che si porta ad un valore più alto di quello della temperatura T<sub>a</sub>. Questo aumento è tanto maggiore quanto più elevata è la potenza dissipata.

La resistenza termica Rtha è un coefficiente termico, denominato "resistenza termica giunzione-ambiente", tipico di ciascun transistore, che indica di quanti gradi centigradi aumenta la temperatura della giunzione per ogni watt di potenza dissipato sul collettore.

In pratica si può dire che la resistenza termica R<sub>tha</sub> definisce l'attitudine del transistore considerato a cedere all'ambiente esterno, attraverso il proprio contenitore, il calore prodotto nel suo interno a causa della potenza dissipata.

In corrispondenza della massima temperatura di giunzione  $T_{jmax}$  ammessa, si otterrà dunque la massima potenza  $P_{max}$  che il transistore può dissipare, secondo la relazione:

$$P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_a}{R_{tha}}.$$

Questa formula consente quindi di calcolare la massima potenza che un transistore, supposto in aria libera, può dissipare.

Tenendo presente quanto detto precedentemente a proposito della resistenza termica  $R_{tha}$ , è intuitivo che, aumentando la superficie del contenitore, ad esempio corredandolo di un dissipatore termico o di alette di raffreddamento, è possibile aumentare la massima potenza dissipabile. In questo caso la resistenza termica giunzione-ambiente  $R_{tha}$  può essere più convenientemente considerata la somma di due parti e cioè:

$$R_{tha} = R_{thc} + R_{thd}$$

dove

Rthc è la resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore;

Rthd è la resistenza termica del dissipatore (o più precisamente fra il dissipatore e l'ambiente).

Dopo questa spiegazione preliminare, possiamo esaminare ora i dati riportati sul presente manuale.

Il valore di potenza P indicato è quello massimo che il transistore può dissipare in aria libera, cioè senza alette di raffreddamento; esso è normalmente riferito ad una temperatura  $T_a = 25$  °C, salvo i casi in cui è specificato espressamente un valore di  $T_a$  diverso.

Si può osservare in ogni caso che è sempre possibile calcolare la potenza massima  $P_{\rm X}$ , dissipabile in aria libera ad una temperatura ambiente di valore qualsiasi  $T_{\rm ax}$ , applicando la seguente formula:

$$P_{x} = P \cdot \frac{T_{j} - T_{ax}}{T_{j} - T_{a}}$$

dove

P è la potenza massima riferita alla temperatura ambiente Ta;

T; è la temperatura massima della giunzione:

Tax è la temperatura ambiente in corrispondenza della quale si vuole calcolare la potenza Px;

Ta è la temperatura ambiente, letta sulla tabella, per la quale si ottiene la potenza nota P.

#### **ESEMPIO**

Per il transistore AC116 sono riportati i seguenti dati:

$$P = 145 \text{ mW}$$
  $T_{j} = 90 \text{ °C}$ 

Poiché non è indicato uno specifico valore di  $T_a$ , si intende che questa potenza è valida per una temperatura ambiente  $T_a = 25$  °C.

Supponiamo ora di voler conoscere la potenza massima  $P_X$  che il transistore AC116 è ancora in grado di dissipare ad una temperatura ambiente  $T_{ax} = 45$  °C.

Applicando la formula 3) si trova:

$$P_{x} = P \cdot \frac{T_{j} - T_{ax}}{T_{j} - T_{a}} = 145 \cdot \frac{90 - 45}{90 - 25} = 145 \cdot \frac{45}{65} = \frac{6.525}{65} \approx 100 \text{ mW}.$$

La potenza massima che il transistore AC116 può dissipare a temperatura ambiente  $T_{ax}$  = 45 °C risulta dunque di soli 100 mW.

In altri casi il valore massimo di potenza P indicato sui dati è riportato in funzione, oltre che della temperatura T<sub>a</sub>, di una specifica aletta per il raffreddamento o per il fissaggio su un dissipatore di calore, le cui caratteristiche sono espressamente chiarite.

Alcuni tipi di alette, di tipo standard, sono state numerate e le loro dimensioni sono riportate al termine del Prontuario (Dati Transistori 2).

In molte situazioni pratiche, essendo nota la resistenza termica giunzione-contenitore R<sub>thc</sub> e fissata la temperatura ambiente di funzionamento T<sub>a</sub>, è opportuno conoscere qual è la resistenza termica del dissipatore di calore R<sub>thd</sub>, necessario perché la temperatura di giunzione non superi il limite assoluto T<sub>imax</sub>.

In questo caso, si calcola dapprima la resistenza termica R<sub>tha</sub> con la formula:

$$R_{tha} = \frac{T_j - T_a}{P}$$

Nota dai dati la resistenza termica Rthc, tenendo presente la relazione 2) si potrà trovare poi la resistenza termica del dissipatore Rthd, data da:

ESEMPIO

Siano  $T_j = 125$  °C la temperatura massima della giunzione  $T_a = 60$  °C la temperatura massima ambiente P = 1 W la potenza massima da dissipare

Applicando la formula 4) si ottiene:

$$R_{tha} = \frac{T_j + T_a}{P} = \frac{125 - 60}{1} = 65 \text{ °C/W}.$$

Se la resistenza termica giunzione-contenitore è  $R_{thc}$  = 50 °C/W, la resistenza termica del dissipatore  $R_{thd}$  dovrà essere:

$$R_{thd} = R_{tha} - R_{thc} = 65 - 50 = 15 \text{ °C/W}$$

(nel caso particolare in cui il dissipatore dovesse essere elettricamente isolato dal contenitore del transistore, mediante opportuna rondella isolante, occorrerà tener conto anche della resistenza termica di contatto fra contenitore e dissipatore. In pratica, al valore di Rthd calcolato nel modo su

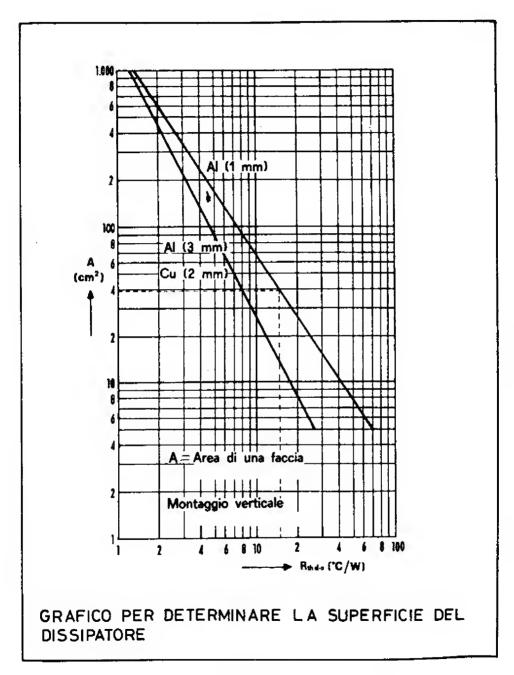


Fig. 1

indicato potrà essere sottratto un valore di resistenza termica compreso fra 0,2 e 1 °C/W).

Nota la resistenza termica del dissipatore, la sua superficie può essere trovata mediante il grafico della fig. 1.

Per l'esempio considerato, in corrispondenza di  $R_{thd}$  = 15 °C/W si trova 39 cm², che è la superficie del dissipatore di calore di alluminio (spesso 1 mm) necessario per il raffreddamento del transistore.

Il dissipatore deve avere preferibilmente forma quadrata. Nel caso di forma rettangolare, la lunghezza del lato piú corto deve essere almeno due terzi di quella del lato maggiore.

Sovente, infine, nel caso di transistori di grande potenza, il valore limite di dissipazione indicato dal costruttore è quello massimo teorico, corrispondente all'impiego di un dissipatore infinitamente grande, di modo che la sua temperatura coincida praticamente con la temperatura ambiente.

Ne risulta che, in tali condizioni ipotetiche, la resistenza termica giunzione-ambiente è identica alla resistenza termica giunzione-contenitore  $(R_{tha} = R_{thc})$ .

Sui dati riportati è precisata, in questi casi, la temperatura massima ammessa del contenitore  $T_c$ , per la quale si ha, con dissipatore infinito, il valore di potenza massimo, dato da:

$$P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_c}{R_{thc}}$$

Si fa presente che questo valore di potenza è puramente teorico, non essendo realizzabile in pratica un dissipatore infinitamente grande. La potenza che il transistore potrà dissipare in condizioni reali di funzionamento sarà sempre inferiore.

Questo modo di indicare la potenza, che sembra a prima vista non essere utile in pratica, serve invece per fare il calcolo senza tener conto del tipo di aletta che verrà usato.

Infatti, dare la P<sub>max</sub> è come indicare la resistenza giunzione-contenitore essendo:

$$R_{thc} = \frac{T_j - T_c}{P_{max}}$$

Ottenuto questo valore, se si conosce la resistenza termica Rthd del dissipatore che si intende adottare, si può calcolare la resistenza termica giunzione-ambiente Rtha con la relazione:

In base al valore di R<sub>tha</sub> cosí calcolato si può risalire con la formula 1) al valore massimo reale di potenza dissipabile in funzione della temperatura ambiente T<sub>a</sub> e del dissipatore prescelto. Diversamente, nota la potenza che il transistore deve dissipare e la temperatura ambiente, si calcola il valore della resistenza termica giunzione-ambiente R<sub>tha</sub> con la relazione 4) e si procede poi come già visto in precedenza per determinare le dimensioni del dissipatore da usare.

#### 6. - DATI ELETTRICI CARATTERISTICI

Le proprietà elettriche dei transistori possono essere rappresentate sotto forma di quantità numeriche, dette PARAMETRI, le quali indicano le relazioni esistenti tra le tensioni e le correnti all'ingresso ed all'uscita.

Sul prontuario sono stati riportati i parametri che di solito interessano di più, e che ora saranno brevemente descritti.

L'amplificazione statica di corrente h<sub>FE</sub> (connessione ad emettitore comune) è il rapporto:

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$$

per specificati valori di corrente IC e di tensione VCE; poiché la dipendenza

dalla tensione  $V_{CE}$  è piccola, talvolta il valore di  $h_{FE}$  è dato solo in funzione di  $I_{C}$  .

Il guadagno di corrente statico  $h_{\rm FE}$  è indicativo dell'attitudine del transistore ad amplificare le frequenze molto basse, ed in tale campo la sua dipendenza dalla frequenza può ritenersi trascurabile.

L'amplificazione dinamica (cioè in corrente alternata) di un transistore nella connessione ad emettitore comune è definita invece dal parametro  $\beta$ , che indica il rapporto tra la variazione della corrente di collettore (per tensione di collettore costante) e la variazione corrispondente della corrente di base che l'ha provocata.

Il valore di  $\beta$  riportato sul prontuario è riferito alla frequenza convenzionale di 1 kHz.

Sovente un dato tipo di transistore viene suddiviso dal costruttore in diverse classi di guadagno (sia statico sia dinamico), contraddistinte con numeri, lettere o punti colorati; per ciascuna classe sono stati riportati, in questi casi, o il valore tipico o i valori minimo e massimo del guadagno (hFE oppure  $\beta$ ) corrispondente per specificati valori di  $I_C$  e  $V_{CE}$ .

Il guadagno di corrente dinamico  $\beta$ , sensibilmente costante per le frequenze basse, decresce invece rapidamente con le frequenze alte.

La frequenza di taglio f $\beta$  è la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico  $\beta$  è sceso al 70,7 % del valore a 1 kHz.

La frequenza di transizione  $f_T$ , detta anche prodotto guadagno-ampiezza di banda, è invece la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico  $\beta$  raggiunge l'unità.

La frequenza di taglio  $f\beta$  e la frequenza di transizione  $f_T$  sono legate approssimativamente dalla seguente relazione:

$$f_T = \beta \cdot f\beta$$

dove  $\beta$  è il guadagno a 1 kHz ad emettitore comune.

Per definire il comportamento di un transistore amplificatore in alta frequenza si riportano i valori del guadagno di potenza, che può essere espresso in diversi modi, a seconda delle condizioni di lavoro e delle condizioni circuitali in cui si trova il transistore.

Il guadagno di potenza Gp è definito come il rapporto fra la potenza trasferita al carico e la potenza in ingresso: esso è, per dati parametri, funzione solo dell'impedenza del carico ed è indipendente da quella del generatore.

Il guadagno di potenza Gtr è il guadagno dato dal rapporto fra la potenza trasferita al carico e la potenza disponibile dal generatore di ingresso; esso quindi dipende sia dall'impedenza del generatore che dall'impedenza del carico.

Il guadagno massimo di potenza G<sub>UM</sub> invece è il guadagno dato come rapporto fra la potenza in uscita e quella di ingresso, nelle condizioni di carico perfettamente adattato e circuito neutralizzato con rete passiva senza perdita.

L'ammettenza di trasferimento indicata y fe (connessione ad emettitore comune) o y fb (connessione a base comune), infine, definisce praticamente la transconduttanza del transistore, cioè il rapporto fra la variazione della corrente di uscita  $I_{\rm C}$  e la corrispondente variazione della tensione di ingresso  $V_{\rm BE}$ .

Questo parametro è funzione delle condizioni di lavoro e soprattutto della frequenza f di funzionamento.

Si fa presente che i valori di tensione V<sub>CE</sub> e di I<sub>C</sub> riportati sul prontuario, quando è riportato il parametro y<sub>fb</sub>, sono da intendersi rispettivamente V<sub>CB</sub> ed I<sub>E</sub>.

# DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS {T <sub>a</sub> = 25 °C				RISTICHE 25 °CI	a (mA)	<b>V</b> C(
AC116	PNP TO-1K	Ampl. pilota BF	VCEO: 18 V VCBO: 30 V IC: 0,2 A	P : 145 mW Tj : 90 °C Rthc : 200 °C/W	giallo verde	ß	: 55 - 95 : 85 - 140 : 65	4 4 20	6 6 1
							. 15 kHz	4	6
	PNP	Ampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 18 V	P : 0,26 W			: 120	50	6
AC117	TO - 1K		V <sub>CBO</sub> : 32 V IC : 1 A	Tj: 90 °C R <sub>thc</sub> :40 °C/W		fβ	: 10 kHz	10	2
AC117P	PNP TO - 1K	Ampl. BF compl. AC175P	Dati tecnici come	AC117 eccetto:		hFE	- 60 - 400	150	2
	PNP	Ampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,15 W	١٧	hFE	: 47	2	
		impiego generale	VCBO : 20 V	Ta : 45 °C	V	bFE	: 78	2	
AC121			IC : 0,3 A	Tj : 90 °C	VI	hFE	: 114	3	
				R <sub>thc</sub> : 50 °C/W	VII		: 200	3	
						$i_{\beta}$	: 17 kHz	20	5
	TO - 1						: 1,5 MHz	20	5
	PNP	Preampl. BF	V <sub>CEQ</sub> : 18 V	P : 130 mW	rosso		: 40 - 65	2	6
			ACBO : 30 A	T <sub>i</sub> : 90 °C	giallo	β	. 55 95	2	6
AC122			IC : 0.2 A		verde	β	: 85 - 140	2	6
					viola	•	: 130 - 200	2	6
					bianco		: 170 - 300	5	6
	TO-18L					fβ	: 15 kHz	4	6
AC122/30	PNP		Impiego e dati te VCEO : 32 V	cnici come AC122 ecce	tto:				
	TO- 18L		VCBO : 45 V						
	PNP	Ampl. pilota BF	V <sub>CEO</sub> : 32 V	P : 145 mW		hFE	: 65	20	1
			VCBO: 45 V	'T <sub>i</sub> : 90 °C	giallo	β	: 55 - 95	4	6
AC123			IC : 0,2 A	Rithe: 200 °C/W	verde	ß	: 85 - 140	4	6
	TO-1K		_			fß	: 15 kHz	4	6
	PNP	Ampl, finale BF	V <sub>CEO</sub> : 32 V	P : 0,26 W		hFE	: 62,5	50	6
AC124		· ·	VCBO : 45 V	Ti 90 °C			: 11 kHz	10	2
	TO-1K		Ic : I A	Rthc . 40 °C/W		۲			
	PNP		1-1					450	
AC124P	TO-1K		Implego e dati te	cnici come AC124 ecce	tta:	MEE	: 60 - 170	150	2
	PNP	Preampi. e	VCEO : 12 V	P : 0,5 W		hFE	: 100	2	5
		pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>a</sub> · 45 °C			: 125	2	5
AC125			IC : 0,1 A	aletta n. 3 e			: 1,7 MHz	10	2
A4 160				diss. 12,5 cm <sup>2</sup>		fβ	: 17 kHz	10	2
				T <sub>j</sub> : 90 °C					
	<b>TO-1</b>			R <sub>tha</sub> : 300 °C/W					
. —	PNP	Preampl. e	VCEO : 12 V	P : 0,5 W		hee	: 140	2	5
		pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>a</sub> : 45 °C		-	: 180	2	5
AC126			Ic : 0,1 A	aletta n. 1 e			: 2,3 MHz	10	2
AG 120				diss. 12,5 cm <sup>2</sup>		ŧβ	: 17 kHz	10	2
				T <sub>j</sub> : 90 °C		-			
	TO-1								

SIGLA	TIPO CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T <sub>a</sub> = 25 °C		CARATTERISTICHE (T <sub>a</sub> = 25 °C)	# Ic (mA)	V <sub>CE</sub>
AC127	NPN TO - 1	Pilota e finale BF compl. AC128 o AC132	VCEO : 12 V VCBO : 32 V IC : 0,6 A	P : 0,34 W Ta : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm² Tj : 90 °C Rtha : 370 °C/W Rthc : 110 °C/W	hFE: 100 f <sub>T</sub> : 2,5 MHz f <sub>β</sub> : 20 kHz	20 10 10	2
AC128	PNP TO - 1	Finate BF compl. AC127	VGEO : 16 V VGBO : 32 V IC : 1 A	P: 1 W aletts n. 1 e diss. 12,5 cm <sup>2</sup> T <sub>i</sub> : 90 °C Rtha: 290 °C/W Rthe: 40 °C/W	heE : 100 f <sub>T</sub> : 1,5 MHz f <sub>β</sub> : 15 kHz	50 10 10	2 2
AC129	PNP C - 18	Preampl. BF basso rumora	V <sub>CEO</sub> : 6 V V <sub>CBO</sub> : 9 V I <sub>C</sub> : 10 mA	P : 12 mW T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 60 °C	β : 40 - 135 fβ : 25 kHz	0,25	2
AC130	NPN TO - 1	Stadi sincr. orizz, TV	V <sub>CEO</sub> : 10 V V <sub>CBO</sub> : 20 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	P:145 mW T <sub>j</sub> : 90 °C	hFE:>25 f <sub>T</sub> :>2 MHz	10 10	1
AC131	PNP TQ-18L	Ampl, finale BF	V <sub>CEO</sub> : 18 V V <sub>CSO</sub> : 30 V I <sub>C</sub> : 1 A	P : 215 mW T <sub>j</sub> : 90 °C	hFE: 100 fβ: 10 kHz	50 10	2
AC131P	PNP TO-18L	Ampl, BF compl. AC186P	Dati tecnici come	AC131 eccetto:	hFE : 60 - 400	150	2
AC131/30	PNP .	Ampl. BF compl. AC186P	VCEO : 32 V VCBO : 45 V IC : 1 A	P : 215 mW T <sub>i</sub> : 90 °C	heE: 100 fg : 10 kHz	50 10	2
AC132	PNP TO -1	Finale 8F compl. AC127	VCEQ : 12 V VCBO : 32 V IC : 0,2 A	P: 0,5 W T <sub>a</sub> : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm <sup>2</sup> T <sub>j</sub> : 90 °C Rtha: 300 °C/W Rthc: 50 °C/W	hfE: 135 fT : 2 MHz fg : 17 kHz	20 10 10	2 2
AC134	PNP TO-1	Ampl. pilota BF	VCEO : 18 V VCBO : 20 V IC : 35 mA	P : 0,15 W	β : 35 fβ : 650 kHz f <sub>T</sub> : 0,8 MHz	1 1	6 6
AC135	PNP TO -1	Ampt, finale BF	VCEO: 18 V VCBO: 20 V IC: 0,2 A	P:0,15 W	β : 65 f <sub>T</sub> : 0,8 MHz	50	1
AC136	PNP TO-1	Ampl. finale BF	VCEO : 25 V VCBO : 25 V IC : 0,2 A	P : 0,15 W	β: 75 f <sub>T</sub> : 0,8 MHz	50	1
AC137	PNP TO-1	Preampl, BF basso rumore	VCEO : 32 V IC : 35 mA	P : 0,15 W	β : 170 I <sub>T</sub> : 0,5 MHz	5	1

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T <sub>a</sub> = 25 °C)	IMI		TTERISTICHE r <sub>a</sub> = 25 °C)	a	Ic (mA)	V <sub>CE</sub>
AC138	PNP	Ampl, pilota BF Commutazione	V <sub>CEO</sub> : 20 V V <sub>CBO</sub> : 25 V I <sub>C</sub> : 1,2 A	P : 0,72 W Ta : 45 °C sletta n. 1 con diss. alluminio 12,5 cm <sup>2</sup> , spessore 1 Tj : 90 °C	,5 mm	β : 30 - 250 † <sub>T</sub> : 1,2 MHz		5	6
AC139	PNP TO - 1	Ampl, finale BF Commutazione	Dati tecnici come / VCBO : 32 V IC : 1 A	AC138 eccetto:		hFE: 40-110 f <sub>T</sub> : 1,8 MHz		400	
AC141	NPN TO-1	Ampl. finale BF Commutazione	Dati tecnici come /	AC138 eccetto:		hFE: 40 - 110 fT: 2,4 MHz		400	
AC141B	NPN TO - 1		Impiego e dati tecr	ici come AC138.					
AC141K	NPN TO-1K	Ampl. finale BF	VCBO : 32 V IC : 1,2 A	P: 0,86 W Ta: 45 °C con diss. alluminlo 12,5 cm <sup>2</sup> , spessore 1 Tj: 90 °C	,5 mm	hFE: 40 - 110 f <sub>T</sub> : 2,4 MHz		400	
AC142	PNP TO-1		Impiego e dati tecr VCBO : 32 V	ici came AC138 eccet	to:				
AC142K	PNP TO-1K		Implego e dati tecr	iici come AC141K ecc	etto:	f <sub>T</sub> : 1,2 MHz			
AC150	PNP TO-18L	Preampl. BF basso rumore	VCEO : 18 V VCBO : 30 V IC : 50 mA	P : 0,1 W T <sub>I</sub> : 75 °C	giallo verde viola bianco	$\beta$ : 55 - 95 $\beta$ : 85 - 140 $\beta$ : 130 - 200 $\beta$ = 180 - 300 $i\beta$ : 15 kHz		2 2 2 2 2 4	6 6 6 6
AC151	PNP	Ampl, 8F uso generale	VCEO : 24 V VCBO : 32 V IC : 0,2 A	P : 0,15 W Ta : 45 °C Tj : 90 °C Rthc : 50 °C/W	IV V VI	β : 50 - 100 β : 75 - 150		2 2 2 3 2 1	1 1 1 . 1 0,5 5
AC151r	PNP TO-1	Ampl. BF uso generałe	Dati tecnici come /	AC151 ma suddiviso so uadagno IV, V, VI.	olo				
AC152	PNP	Ampl. BF compl. AC127	VCEO : 24 V VCBO : 32 V IC : 0,5 A	P : 0,15 W Ta : 46 °C T; : 90 °C Rtive : 50 °C/W	٧	hfE: 30 - 60 hFE: 50 - 100 hFE: 75 - 150 fβ: 15 kHz fT: 1,5 MHz		2 2 3 5 5	<b>5</b>
AC153	PNP	Ampl. BF compt. AC176	VCER: 32 V (RBE: ≤500 Ω) VCBO: 32 V IC: 1 A	P : 1 W T <sub>C</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 90 °C R <sub>tha</sub> : 300 °C/W R <sub>the</sub> : 40 °C/W		h#E: 66 hFE: 97 h#E: 167 fβ: 15 kHz fy: 1,5 MHz.		50 50 50 10	2 2

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C		CARATTERISTICHE (T <sub>a</sub> = 25 °C)	a Ic (mA)	V <sub>CE</sub>
AC153K	PNP	Ampl, BF compl. AC176K	V <sub>CER</sub> : 32 V (R <sub>BE</sub> : ≤500 Ω) V <sub>CBO</sub> : 32 V	P: 1 W Te: 45 °C Tj: :90 °C	V hFE: 66 VI hFF: 97 VII hFE: 167	50 50 50	
	TO-1K		lc : 1 A	R <sub>the</sub> : 45 °C/W	fβ : 15 kHz f <sub>T</sub> : 1,5 MHz	10 10	2
	PNP	Preampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 10 V	P : 50 mW	rossσ β : 35- 65	0,3	4,5
		basso rumore	VCBO : 15 V	T <sub>j</sub> : 75 °C	giatio $\beta$ : 55 - 100	0,3	4,5
AC160			lC : 10 mA		verde $\beta$ : 80 - 150	0,3	4,5
	TO - 181,				viola β . 120 - 250	0,3	4.5
	10-161				f <sub>T</sub> : 2 MHz	0,3	4,5
	DNID						
	PNP	Ampl. BF	VCEO : 24 V	P : 0,15 W	hFE : 93	2	5
AC162			V <sub>CBO</sub> : 32 V	Ta : 45 °C	β : 80 - 170	2	6
	TO - 1		IC : 0,2 A	Tj : 90 °C	fβ : 17 kHz	10	5
				R <sub>thc</sub> : 50 °C/W	f <sub>T</sub> : 1,7 MHz	10	2
	PNP	Ampl. BF	VCEO : 24 V	₽ : 0,15 W			
		runpi. Di	VCBO : 32 V	T <sub>a</sub> : 45 °C	hpg : 125	2	5
AC163			IC : 0,2 A	T <sub>j</sub> : 90 °C	β : 130 - 300	2	5
	TO-1			Rthc: 50 °C/W	fβ : 17 kHz f <sub>T</sub> : 2,3 MHz	10	2
				minc : 30 -C/N	17 : 2,3 mmz	10	2
	PNP	Preampl. e	VCEO : 15 V	P : 90 mW	hFE: 125	2	5
AC170		pilota BF	VCBO : 32 V	Ta: 45 °C	$\beta$ : 80 - 170	2	6
			IC : 0,2 A	τ <sub>j</sub> : 90 °C	f <sub>β</sub> : 17 kHz	10	2
	TO-18L				fT : 1,7 MHz	10	2
	PNP	Preampl, e	VCEO : 15 V	P : 90 mW	hFE : 180	2	5
		priota BF	VCBO : 32 V	Ta: 45 °C	β : 130 - 300	2	6
AC171			IC : 0,2 A	Ti : 90 °C	f <sub>B</sub> - 17 kHz	10	2
	TO-18L			.,	f <sub>T</sub> : 2,3 MHz	10	2
	NPN	Preampl, BF	V <sub>CEO</sub> : 32 V	P : 0,2 W	β : 45·110	1	5
AC172	141.14	basso rumore	VCBO : 32 V	T <sub>i</sub> : 90 °C	f <sub>T</sub> : 2,5 MHz	10	2
	TO-1		IC ; 10 mA	11 00 0	7 . 2,3 11112		-
	Albai	4 15 155					
AC175	NPN	Ampl, finale BF	VCEO : 18 V	P : 0,26 W	hpg : 165	50	6 2
10170	TO-1K		VCBO: 25 V JC: 1 A	T <sub>j</sub> : 90 °C B <sub>thc</sub> : 40 °C/W	1β : 20 kHz	10	2
	70-110		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ning . 40 -C/4			
	NPN	Ampi. BF					
AC175P	TO-1K	compl. AC1 17P	Dati tecnici come A	AC175 eccetto:	hFE:100-400	150	2
	NIDAL	4 05	45.14				
	NPN	Ampl, BF compl. AC153	V <sub>CEO</sub> : 18 V V <sub>CBO</sub> : 32 V	P : 1 W T <sub>C</sub> : 45 °C	hpe : 35 fg : 15 kHz	50 10	2
AC176		compi. AC155	IC : 1 A	T <sub>1</sub> : 90 °C	β : 15 KHZ f <sub>T</sub> : 3 MHz	10	2
	TO-1			Bthc : 40 °C/W	17 . 3 14/12	10	4
				-			
	NPN	Ampl. BF	VCEO : 18 V	P : 1W	hFE: 35	50	2
AC17BK		compl. AC153K	V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>C</sub> : 45 °C	f <sub>7</sub> : 3 MHz	10	2
	TO-1K		₹C : 1 A	Tj : 90 °C Rthc : 45 °C/W			
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 15 V	P : 0,18 W	hFE : 185	50	2
C178		compl. AC179	VCBO : 20 V	Ta : 45 °C	fβ : 10 kHz	10	2
.01/4			IC : 0,7 A	τ <sub>i</sub> : 90 °C			
	TO-1K			Rthc: 40 °C/W			

SIGLA	TIPO 6 CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T <sub>a</sub> = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a Ic (mA)	V <sub>CE</sub> (V)
AC178P	PNP TO-1K		Implego e dati tecnici come AC178 e	occetto: hpg: 100 - 400	150	2
	NPN	Ampl. finale BF compl. AC178	VCEO: 15 V P: 0,18 W VCBO: 20 V Ta: 45 °C	hp∈:185 f <sub>B</sub> : 20 kHz	50 10	2
AC179	TO - 1 K	compr. AC176	1 <sub>C</sub> : 0,7 A T <sub>j</sub> : 90 °C R <sub>the</sub> : 40 °C/W			•
AC179P	NPN TQ-1K		Impiego e dati tecnici come AC179 ec	ncetto: hFE: 100 - 406	150	2
	PNP .	Ampl, finals BF	VCEO : 16 V P : 0,3 W	V hFE: 50-100	600	1
		compl. AC181	V <sub>CBO</sub> : 32 V T <sub>i</sub> : 100 °C	VI hpg: 75-150	600	1
AC 180			IC : 1,5 A Rthc : 30 °C/W		600	1
				f <sub>T</sub> : 2,5 MHz	1	6
	TO-1			₹β : 20 kHz	1	6
AC180K	PNP TO-1K	Ampl. finale 8F compl, AC1B1K	Dati tecnicí come AC180 eccetto: P : 0,44 W			
				blu hpg : 70	10	1
AC180D			Equivalente all'AC180, ma selezionato		10	1
			per l'impiego negli stadi pilota di BF	bianco hpg : 125 grigio hpg : 195	10 10	1
	NPN	Ampl. finale 8F	V <sub>CEO</sub> : 16 V P : 0,3 W	V hFE: 50-100	600	1
		compl. AC180	VC8O : 32 V Ti : 100 °C	VI hFE: 75-150	600	1
AC181			IC : 1 A Rthc : 30 C/W	VII hFE: 125-250	600	1
			•	t <sub>T</sub> : 4,5 MHz	1	6
	TO-1			fβ : 35 kHz	1	6
AC181K	NPN TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC180K	Dati tecnici come AC181 eccetto: P : 0,44 W			
				blu hpe : 70	10	1
AC181d			Equivalente all'AC181, ma selezionato		10	1
ACIOIO			per l'impiego negli stadi pilota di BF	bianco hre: 125 grigio hre: 195	1 <b>0</b> 10	1
	NPN	Preampl. e	VCEO: 16 V P ; 0,25 W	V β : 75	2	6
	INFIN	pilota BF	VCBO : 32 V Ti : 100 °C	VI β : 110	2	6
AC183		phota by	IC : 0,15 A Rthc : 100 °C/V	V VII β : 170	2	6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			C Table 1	fT : 4,5 MHz	1	6
	10-1			f <sub>β</sub> : 35 kHz	1	6
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 16 V P: 0,27 W	V hee: 50-100	300	:
		compl. AC185	V <sub>CBO</sub> : 32 V T <sub>j</sub> : 100 °C	VI hpg : 75-150	300 300	1
AC184			IC : 0,5 A Rthc : 60 °C/V		300	6
	TO-1			f <sub>T</sub> : 2,5 MHz fβ : 20 kHz	1	6
	,			blu hFE: 70	10	1
			Equivalente all'AC184, ma selezionato		10	1
AC184D			per l'impiego negli stadi pilota di BF	blanco hpg : 125	10	1
				grigio h⊨E:195	10	1

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	SEMI		TERISTICHE , = 25 °C)	a I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>C</sub>
AC185	NPN	Ampl. finale BF compl. AC184	VCEO: 16 V VCBO: 32 V IC: 0,5 A	P : 0,27 W T <sub>J</sub> : 100 °C R <sub>thc</sub> : 60 °C/W	VI	hpe: 50 - 100 hpe: 75 - 150 hpe: 125 - 250	300 300 300	1 1 1
	TO - 1					f <sub>T</sub> : 4,5 MHz f <sub>β</sub> : 36 kHz	1	6 6
					blu	hFE: 70	10	1
			Equivalente all'AC1	185, ma selezionato	viola	hFE : 90	10	1
AC185D			per l'impiego negl	i stadi pilota di BF	blanco "grigio	hfg : 25 hfg : 195	10 10	1
	NPN	Ampl. pilota e	VCB : 18 V	P : 0,215 W		hee: 100	50 10	2 2
AC186	TO - 18L	finale BF	VCBO: 30 V IC: 0,7 A	Tj: 90 °C		fβ : 20 kHz		
AC186P	NPN TO - IBL	Ampl. finale BF compl. AC131P	Dati tecnici come	AC186 eccetto:		hFE: 100 - 400	150	2
	NPN	Ampl. finale BF	VCEO : 15 V	P : 0,56 W		hFE : 300	300	1
AC187		compl. AC188	VCBO : 25 V 1C : 1 A	T <sub>a</sub> : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm <sup>2</sup>		fτ : 3 MHz fβ : 20 kHz	10 10	2
	<b>TO</b> - 1			T <sub>j</sub> : 90 °C R <sub>thc</sub> : 40 °C/W				
	NPN	Ampl. finale BF	VCEO : 15 V	P : 0,64 W		hFE: 91 - 455	50 10	2
AC187K		∞mpl, AC188K	V <sub>CBO</sub> : 25 V I <sub>C</sub> : 1 A	T <sub>a</sub> : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm <sup>2</sup> T <sub>i</sub> : 90 °C		fŢ: 5 MHz fg: 20 kHz	10	
	TO-1K			R <sub>the</sub> : 45 °C/W				
AC 188	PNP TO-1	Ampl. finale BF compl. AC187	Dati tecnici come	AC187 eccetto:		f <sub>T</sub> = 13,5 MHz f <sub>B</sub> = 1.10 kHz	10 10	
AC188K	PNP TO~IK	Ampl, finale BF compl. AC1B7K	Dati tecnici come	AC187K eccetto:		f <sub>T</sub> : 1,5 MHz f <sub>β</sub> : 10 kHz	10 10 	
AC191	PNP	Ampl. BF basso rumore	V <sub>CBO</sub> : 32 V	P:0,43 W T <sub>1</sub> : 90 °C		$eta:$ 30 - 500 $f_{\mathrm{T}}:$ 5,5 MHz	1	6
	TO - 1	Commutazione		<u> </u>				
AC192	PNP TO - 1	Pilota BF Commutazione	VCBO : 32 V IC : 0,25 A	P:0,43 W T <sub>j</sub> : 90 °C		β : 30 - 500 f <sub>T</sub> : 5,5 MHz	1	6
	PNP	Pilota BF Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 32 V	P: 0,72 W aletta n. 1		hFE: 90 - 400 fT: 3 MHz	400	
AC193				con diss. alluminio 12,5 cm <sup>2</sup> , spessore	1.5 mm			
	TO-1			T <sub>j</sub> : 90 °C				
AC193K	PNP TO-1K		Impiego e dati te	cnici come AC193 ecc P : 0,86 W	etto:			
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 30 V V <sub>CBO</sub> : 32 V I <sub>C</sub> : 3 A	P : 30 W T <sub>c</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 90 °C	III IV V	hf£: 49 hfE: 74 hfE: 124	50 50	
AD130		Circuiti alim.	IC : 3 A	Rthc : 1,5 °C/W		fβ : 10 kHz f <sub>T</sub> : 0,35 MHz	800 800	

SIGLA	ONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C			ATTERISTICHE F <sub>a</sub> = 25 °C)	a I <sub>C</sub>	V <sub>CI</sub>
	PNP	Ampl. finale 6F	VCEO : 45 V	P ; 30 W	ш	hFE: 49	50	
		di potenza	VC80 : 64 V	T <sub>C</sub> : 45 °C		hee: 74	50	
AD131		Circuiti alim,	IC : 3 A	τ <sub>1</sub> : 90 °C	V	hpg: 124	50	
				Rthc: 1,5 °C/W		f <sub>T</sub> 0,35 MHz	500	2
	TO -3					fβ . 10 kHz	500	2
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 60 V	P : 30 W	111	hFE 49	50	
		di potenza	V <sub>CBO</sub> : 80 V	T <sub>C</sub> : 45 °C	tV	bFE : 74	50	
AD 132		Circuiti alim.	1 <sub>C</sub> : 3 A	T <sub>i</sub> : 90 °C	V	h <sub>FE</sub> : 124	50	
				R <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W		f <sub>T</sub> : 0,35 MHz	500	2
	TO-3					fβ : 10 kHz	500	2
	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 32 V	P : 36 W	11)	hFE: 50	500	
		di potenza	VCBO : 50 V	T <sub>C</sub> : 45 <sup>o</sup> C	tV	hFE: 75	500	
AD133		Circuitì alim.	IC : 15 A	Tj : 100 ℃	٧	hFE : 125	500	
				R <sub>the</sub> : 1,5 °C/W		f <sub>T</sub> 0,3 MHz	500	6
	TO-41					fβ 8 kHz	500	6
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 22 V	P : 11 W	IV	hFE: 75	500	
		di potenza	V <sub>CBO</sub> : 40 V	T <sub>C</sub> : 45 °C	V	hpg : 125	500	
AD136		Circuiti alim.	IC : 10 A	T <sub>j</sub> : 100 °C	VI	hFE : 180	500	
		'		Rthc: 5 °C/W		$f_T = 0.3 \text{ MHz}$	500	6
	TO-8					fß BkHz	500	6
	PNP	Ampt, finale BF	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 30 W		hFE: 62,5	500	1,5
AD138			VCBO : 40 V	T <sub>C</sub> : 45 °C		fβ : 5,5 kHz	500	6
WD 130			IC : 8 A	T <sub>j</sub> : 90 °C				
	TÚ-3			R <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W				
	PNP			enici come AD138 eccel	tto:			
AD138/50			V <sub>CEO</sub> : 35 V					
	TO-3		V <sub>CBO</sub> : 70 V					
	PNP	Ampl. tinale BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 13 W		hFE : > 20	10	10
			VCBO: 32 V	T <sub>C</sub> : 38 °C		f <sub>E</sub> : 0,6 MHz	100	2
AD139			IC : 3,5 A	T; : 90 °C		f <sub>β</sub> : 10 kHz	100	2
	SOT-9			R <sub>thc</sub> : 4 °C/W				
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 50 V	P : 30 W		hFE: 50 - 175	1000	2
AD142		Commutazione	VCBO : 80 V	T <sub>C</sub> : 55 °C				
AU 142	TO-3		I <sub>C</sub> : 10 A	T <sub>j</sub> : 100 °C 8 <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W				
	PNP		Impieno e desi to	cnici come AD142 eccet	ito:		r.	
AD143	. 741		VCEO : 30 V	MINE WHITE ECOCI				
	TO -3		VCBO : 60 V					
	PNP		Impiego e dati teo	nici come AD143 eccett	10:			
AD143R			VCEO : 25-V					
	TO-3		VCBO : 32 V					
	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 26 V	P : 13,5 W	IV	hFE: 51	50	
AD148			VCBO: 32 V	T <sub>c</sub> : 45 °C	٧	hFE: 85	50	2
			IC : 3,5 A	T <sub>j</sub> : 100 °C		f <sub>T</sub> : 0,45 MHz	500	2
	SOT-9			R <sub>thc</sub> : 4 °C/W		fβ : 12 kHz	500	2

SIGLA	TIPO	IMPIEGO	VALORI MAS			ERISTICHE	a	lc	Vc
	CONT.		(T <sub>a</sub> ± 25 °C		(la	= 25 °C}		(mA)	(V
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 27,5 W	IV h	FE : 50		50	1
D. 4.00			VCBO : 50 V	Tc : 45 °C	V h	FE : B2		50	1
D149			IC : 3,5 A	T; : 100 °C	f-	: 0,5 MHz		500	2
	TO-3			R <sub>thc</sub> : 2 °C/W		3 : 10 kHz		500	2
	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 30 V	P : 27,5 W	I <b>V</b> h	FE: 50		50	1
D150			V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>C</sub> : 45 °C		FE: 82		50	1
			IC : 3,5 A	Т <sub>ј</sub> : 100 °С		T : 0,45 MHz		500	2
	TO · 3			Athc: 2 °C/W		β : 12 kHz		500	2
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 23 V	P:6W		FE : 83		50	6
D152			V <b>∂</b> BO : 45 V	T <sub>C</sub> : 45 °C	f	β : 11 MHz		10	2
			Ic : 1 A	Tj : 90 °C					
	SOT-9			R <sub>thc</sub> : 7,5 °C/W	· .			_	
	PNP	Ampl. finale BF	VCEQ : 15 V	P . 6W		FE : 126		50	6
AD 155		•	V <sub>CBO</sub> : 25 V	T <sub>C</sub> : 45 °C	f	ß: I1 kHz		10	2
4D 130			Ic : 1 A	Tj : 90 °C					
	SQT-9			R <sub>thc</sub> : 7,5 °C/W					
AD155P	PNP		Impiano a dati ta	onici come AD155 eccetto	. 1	FE: 65 - 320		500	1
101001	SOT-9		improgo e deti to						
	PNP	Commutazione e	VCEO : 18 V	P : 9W		FE: 83		500	0,5
AD159		circuiti alim.	VC80 : 40 V	T <sub>C</sub> : 45 °C		T : 0,3 MHz		500	6
10 133	TO -8		FC : 8 A	Tj : 90 °C R <sub>thc</sub> : 5 °C/W *	f	ß: BkHz		500	6
	10-8			nine . 5 com					
	PNP	Commutazione e	VCEO : 22 V	P:9W		FE : 155		500	0,5
		circuiti alim.	VCBO: 40 V	T <sub>C</sub> : 45 °C	f	T : 0,3 MHz		500	6
AD 160			IC : 10 A	T; : 90 °C	f	β: 8kHz		500	6
	TO-B			R <sub>thc</sub> : 5 °C/W					
	NPN	Ampl, finale BF	V <sub>CEQ</sub> : 20 V	P:4W·	ŀ	FE: 80 - 320		500	1
		compl. AO162	VCBO : 32 V	T <sub>C</sub> : 72 °C	f	T : 3 MH≥		10	2
AD 161			Ic : 1 A	T <sub>i</sub> : 90 °C	f	β:35 kHz		300	2
	SOT - 9			R <sub>thc</sub> : 4,5 °C/W		·	_		
	PNP	Ampl. finate BF	VCEO : 20 V	P : 6W	<b>V</b> 1	FE: 67		50	
		compl. AD161	V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>C</sub> : 63 °C		IFE: 98		50	
			lc : 1 A	T <sub>i</sub> : 90 °C		FE: 170		50	
AD162				Rthc: 4.5 °C/W		FE: 235		50	_
						T : 1,5 MHz		300	2
	SOT-9					β : 15 kHz		300	2
	PNP	Ampl. finale BF e	VCEO: 80 V	P : 30 W		FE: 30		50	
		circuiti alim.	V <sub>C8O</sub> :100 V	T <sub>C</sub> : 45 °C		ife: 49		50	
AD163			4C : 3 A	Tj:90°C		FE: 74		50	
	TO-3			R <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W	_	T : 0,35 MHz B : 10 kHz		500 500	2
						<u> </u>			
	PNP	Ampl, finale BF e	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 6W		FE: 120		50	6
AD 164		circuiti alim.	V <sub>CBO</sub> : 25 V	Tc : 45 °C	1	β : 11 kHz		10	2
AD 104			IC : 1 A	Ti : 90 °C					
	SOT -9			Rthc: 7.5 °C/W					

SIGLA	TIPO CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE (T <sub>a</sub> = 25 °C)		V <sub>CE</sub> (V)	t (MHz
AD184P	PNP SOT -9		Impiego e dati teci	nici come AD164 eccetto:	hFE : 80 - 145	500	1	
AD165	NPN	Ampl, finale BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V V <sub>CBO</sub> : 25 V Ic: 1 A	P : 6,3 W T <sub>C</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> ': 90 °C	hFE: 180 fβ: 20 kHz	50 10	6	
	SOT-9			Rthc: 8,5 °C/W				
AD165P	NPN SOT-9		Implego e dati tec	nici come AD165 eccetto	: hpg : 80 - 345	500	1	
	PNP	Ampt. finale BF	V <sub>CEQ</sub> : 26 V	P : 6W	hFE : 83	50	6	
AD 169			V <sub>CBO</sub> : 45 V I <sub>C</sub> : 1 A	T <sub>C</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 90 °C	fβ : 11 kHz	10	2	
	SOT-9			R <sub>thc</sub> 7,5 °C/W		****		
AD 169P	PNP SOT - 9		Impiego e dati tec	nici come AD169 eccetto	: hFE : 40 - 160	500	1	
	PNP	Ampl. oscill, VHF	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 75 mW	β :>20	1	12	
AF 102	TO - 7		V <sub>CBO</sub> : 25 V IC : 10 mA	T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 75 °C	f <sub>T</sub> ∶180 MHz Y <sub>fb</sub> ∶ 25 mS	1	12 12	200
	PNP	Ampl. RF-FI	V <sub>CER</sub> : 12 V	P : 30 mW	hFE : 50	1	12	
AF105		per OM -OC	$(R_{BF}:30~k\Omega)$	Ta: 45 °C	β : 60	95	6	
A1 100	RO-87		V <sub>C8O</sub> : 25 V	T <sub>j</sub> : 75 °C	y <sub>fe</sub> : 19 mS f <sub>T</sub> : 22 MHz	0,5 0,5	6 6	
	PNP	Preampl, RF	V <sub>CEO</sub> : 18 V	P : 60 m₩	h#E: 70	2	6	
AF106		oscill. conv. VHF	V <sub>CBO</sub> : 25 V	Ta: 45 °C Ti: 90 °C	β : 65 γ <sub>fe</sub> : 36 mS	1	12 12	35
A. 100	TO - 72		IC : 10 mA	11 : 90 -0	f <sub>T</sub> : 220 MHz		12	55
AF106A	PNP TO - 72		Impiego e dati teo	nici come AF106 eccetto	. h <sub>FE</sub> : 20	1	12	
	PNP	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 60 mW	hFE ; 55	2	6	
AF109R	TO - 72	fino a 260 MHz	VĆBO: 20 V IC: 10 mA	Ta: 45 °C T <sub>i</sub> : 90 °C	γ <sub>fb</sub> : 22 mS f <sub>T</sub> : 260 MHz	1,5	12	200
	PNP		Impiego e dati teo	nici come AF124 eccetto				
AF114	TO-7			P : 50 mW T <sub>a</sub> : 45 °C				
AF115	PNP		≩mpiego e dati teo	nici come AF125 eccetto P : 50 mW	τ			
Artis	TO-7			Ta: 45 °C				
4.F.4.ED	PNP		Impiego e dati ted	nici come AF126 eccetto P : 50 mW	d			
AF11B	TO-7			T <sub>e</sub> : 45 °C				
AF117	PNP TO-7		Implego e dati tec	nicl come AF127				
	PNP	Ampl. finale	VCEO : 70 V	P : 0,4 W	hFE : 180	10	2	10.7
AF118		video TV	VCBO : 70 V IC : 30 mA	aletta n. 4 Tj. : 75 °C	y <sub>fe</sub> : 130 mS f <sub>T</sub> : 175 MHz	10 10	6 5	10,7
	TO-7		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R <sub>the</sub> : 250 °C/W	.1		-	

IMPLEGO T.	VALORI MASS		CARATTERISTICHE (T <sub>a</sub> = 25 °C)			(MHz
Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P: 65 mW	hpg: 75	3	10	
oscili. AM - FM	VCBO : 25 V	Ta : 45 °C	y <sub>fe</sub> : B0 mS	3	10	35
fino a 100 MHz	IC · 10 mA	Tj : 7S °C	G <sub>tr</sub> : 19 dB	2	5	100
72LR		R <sub>thc</sub> : 220 °C/W	f <sub>T</sub> : 270 MHz	3	10	
Ampl. RF-FM	VCEO : 15 V	P . 40 mW	hFE : 140	1	6	
lino a 100 MHz	VCBO: 32 V	Ta : 45 °C	β : 150	1	6	
	IC : 10 mA	T <sub>i</sub> : 75 °C	yfb : 150 mS	1	6	100
72R		R <sub>thc</sub> : 400 °C/W	G <sub>p</sub> : 14 dB f <sub>T</sub> : 75 MHz	1	6 6	100
			<u> </u>			
Ampl. RF - FI	VCEO : 15 V	P : 40 mW	hFE: 140	1	6	
oscill, fino a	VCBO : 32 V	Ta : 45 °C	β : 150	1	6	40.7
27 MHz	IC : 10 mA	T <sub>j</sub> : 75 °C	y <sub>fe</sub> : 34 mS	1	6	10,7
72R		R <sub>thc</sub> : 400 °C/W	G <sub>O</sub> : 13 dB f <sub>T</sub> : 75 MHz	1	<b>6</b>	100
720			<u> </u>			
Ampl. RF-FI	VCEO : 15 V	P : 40 mW	hFE: 140	1	6	
lino a 16 MHz	VCBO: 32 V	Ta : 45 °C	β : 150	1	6	
	IC : 10 mA	T <sub>j</sub> 75 °C	y <sub>fe</sub> : 32 mS	1	6	10,7
		Rthc: 400 °C/W	G <sub>p</sub> : 25 dB 1 <sub>T</sub> : 75 MH2	1	6 6	10,7
72 R			IT . 75 minz			
Ampl. RF-FI	VCEO : 15 V	P : 40 mW	hFE : 140	1	6	
fino a 6 MHz	V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>a</sub> : 45 °C	β : 1 <b>50</b>	1	6	
	IC : 10 mA	T <sub>j</sub> : 75 °C	v <sub>fe.</sub> : 37 mS	1	6	0,49
.72A		R <sub>thc</sub> : 400 °C/W	G <sub>p</sub> : 42 dB 1 <sub>T</sub> : 75 MHz	1	6	0,49
			<u> </u>			
Ampl. RF	VCEO: 6 V	P : 12 mW	β : 25 - 135 f <sub>T</sub> : 6 MHz	0,25	10	
per OM-OC	V <sub>CBO</sub> : 9 V	T <sub>a</sub> : 45 °C	1.4 : D. MILLE	0,25	"	
8	Ic : 10 mA	T <sub>j</sub> : 60 °C			_	
Ampl. RF per VHF	VCER : 18 V	P : 60 mW	β : 110	1	6	100
	(Rge : 30 k $\Omega$ )	Ta: 45 °C	у <sub>fb</sub> : 22 mS	1	6	100
-72L	V <sub>CBO</sub> : 25 V	T <sub>i</sub> : 75 °C	f <sub>T</sub> : 55 MHz	1		
Ampl RF per VHF	V <sub>CER</sub> : 18 V	P:60 mW	$\beta$ : 100	1	6	100
	$(R_{BE}:30 k\Omega)$	Ta: 45 °C	У <sub>1b</sub> : 21 m\$	1	6	104
- <b>7</b> 2L	V <sub>CBO</sub> : 25 V	т <sub>і</sub> : 75 °С	f† : 50 MHz	1		
Ampl. RF	V <sub>CER</sub> : 18 V	P . 60 mW	β : 80	1	6	
oscill. conv.	(RBE : 30 kΩ)	Ta: 45 °C	γ <sub>te</sub> :36 mS	1	6	2
- 72L	VCBO : 25 V	τ <sub>j</sub> : 75 °C	fy : 40 MHz	1	6	
P Ampl. RF · FI	VCER : 18 V	P : 60 mW	β : 60	1	6	10,
per MA-MF	(R <sub>BE</sub> : 30 kΩ)		Yie : 36 mS	i	6	,,,
- 72L	VCBO : 25 V	T <sub>j</sub> : 75 °C	†T : 35 MHz			
P Ampl El	Dati tecnici com	e AF137 eccetto.	β ; 1 <b>00</b>	1		
-72L per MA-MF	221 (100)		f <sub>T</sub> : 40 MH	z 1	 	
O Amul PE	Veso : 15 V	P : 60 mW	hFE : 56			
			Van. 1 1 194 770	5 1		. 80
			Gust : 37,5 an	0,1		80
	iç itina	-1 0	14 . 1 160 M	Hz 1,5	12	
P - 72 P	Ampl. RF oscill. conv. UHF fino a 860 MHz	Ampl. RF VCEO : 15 V oscill. conv. UHF VCBO : 20 V fino a 860 MHz 1C : 10 mA	Ampl. RF VCEO : 15 V P : 60 mW oscill. comv. UHF VCBO : 20 V T <sub>a</sub> : 45 °C fine a 860 MHz fc : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	Ampl. F1 per MA-MF	Ampl. FI Dati tecnici come AF137 eccetto:  1. per MA-MF  Ampl. RF VCEO: 15 V P: 60 mW hFE: 56 mS 1 oscili. conv. UHF VCBO: 20 V Ta: 45 °C yfb: 1,5 mS 1 fino a 860 MMz 1C: 10 mA Tj: 90 °C Gust: 14,5 dB 1,5	Ampl. FI Dati tecnici come AF137 eccetto.  1. per MA-MF  Ampl. RF VCEO: 15 V P: 60 mW hFE: 56 2 6 9 12 12 12 14 15 12 12 14 15 12 12 14 15 15 12 14 15 15 12 15 12 15 15 12 15 15 12 15 15 12 15 15 12 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

SIGLA	TIPO 8 CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI {T <sub>a</sub> = 25 °C}	CARATTERISTICHE a (T <sub>a</sub> = 25 °C)	Ic (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	f {MHz
AF142	PNP	Ampl. RF per MF	VCBQ: 30 V P: 80 mW IC: 10 mA Ti: 90 °C	β : 100 9 <sub>fb</sub> : 18 mS	1,5 1	6 9	100
	TO - 7		•	f <sub>T</sub> : 150 MHz			
AF143	PNP	Oscill, conv. per MF	V <sub>CBO</sub> : 30 V P : 80 mW IC : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	β ; 85 γ <sub>fb</sub> : 15 mS	1,5 1	6 9	100
	TO-7		75-47-1	f <sub>T</sub> : 130 MHz			
AF144	PNP	Ampl, FI per MA-MF	V <sub>CBO</sub> : 30 V P : 80 mW Ic : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	β : 65 y <sub>fe</sub> : 37 mS G <sub>UM</sub> : 25 dB	1,5 1 1,5	6 8 6	10,7 10,7
	TO - 7			f <sub>T</sub> : 130 MHz	1,5	6	
AF146	PNP TÓ-7	Oscill. conv. per OM-OC	V <sub>CBO</sub> : 30 V P : 80 mW I <sub>C</sub> : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	β:100	1	6	
AF147	PNP TO-7	Amps. RF per MA	V <sub>CBO</sub> : 24 V P : 80 mW IC : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	β:80	1	6	
AF148	PNP TO - 7	Oscitl, conv. per OM-OC	V <sub>CBO</sub> : 24 V P : 80 mW I <sub>C</sub> : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	β:100	1	6	
AF149	PNP TO -7	Ampl. FI per MA	Dati tecnici come AF171				
AF150	PNP TO -7	Ampl. FI per MA	VCBO : 24 V P : 80 mW IC : 10 mA T <sub>j</sub> : 90 °C	β : 70 Yfe : 37 mS G <sub>UM</sub> : 34,5 dB	1 1 1	6 9 6	0,45 0,45
AF164	PNP TO-44		Impiega e dati tecnici come AF142				
AF 165	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF143				
AF166	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF144				
AF168	PNP TO - 44		Implego e dati tecnici come AF146				
AF169	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF147				
AF170	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF148				
AF171	PNP TO - 44	Ampl. FI per MA	V <sub>CBQ</sub> : 24 V P : 80 mW I <sub>C</sub> : 10 mA T <sub>j</sub> : 75 °C	β : 225 G <sub>UM</sub> : 34,6 dB	1	6 6	0,45
AF172	PNP TO - 44		Impiego e dati tecnici come AF150				

SIGLA	TIPO B CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (T <sub>a</sub> = 25 °C)		CARATTE:	RISTICHE (	lc (mA)		f (MHz
AF178	PNP	Ampl. RF oscill. conv. VHF	V <sub>CBO</sub> : 25 V I <sub>C</sub> : 10 mA	P : 50 mW T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 75 °C	β	: > 20 : > 20 : > 25 m\$	1 ! 1	12 12 12	200
	TO-12			•		: 180 MHz	1	12	
AF179	PNP TO-12	Ampl. FI video TV	VCEO : 25 V VCBO : 25 V IC : 10 mA	P : 95 mW Tj : 80 °C Rthc : 170 °C/W		: 80 mS : 270 MHz	3	10 10	35
AF180	PNP TO-12	Ampl, RF per VHF	VCEO : 25 V VCSO : 25 V IC : 20 mA	P : 0,156 mW T <sub>j</sub> : 75 °C		: 35 mS : 14 dB	3,5 3,5	10 10	200 200
AF181	PNP TO - 12	Ampl. F1 video TV Stadio controllato	VCER : 30 V VCBO : 30 V IC : 20 mA	P: 0,156 mW Tj: 75 °C R <sub>thc</sub> : 140 °C/W	Yfe	: 60 : 85 mS : 170 MHz	3 3	10 10 10	35
	PNP	Preampl, RF (punto nero)	V <sub>CEO</sub> : 25 V V <sub>CBO</sub> : 25 V	P : 46 mW Ta : 45 °C		: 9 dB : B20 MHz	2 2	10 10	<b>B</b> 60
AF186	TO - 72L	e conv. oscill.	IC : 15 mA	Tj : 75 °C	nero Yfb	: 18 mS : 22 mS	2	10 13	900 900
	PNP	Ampl. FI video TV	V <sub>CES</sub> : 25 V V <sub>CBO</sub> : 25 V	P : 0,1 W T <sub>a</sub> : 45 °C.		: > 30 : 150	3	10 10	
AF200	TO-72LR		1C : 10 mA	Tj : 90 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	Yte	: 92 mS	3	10	35
AF201	PNP TQ - 72LR	1	Impiego e dati teo	nici come AF200 eccett		: > 20 : 95 mS	3 3	10 10	35
AF202	PNP TO-72LR		Implego e dati teo	mici come AF200 eccett		: > 20 : 95 mS	3 3	10 10	35
	PNP	Ampl. FI video TV	V <sub>CES</sub> : 32 V V <sub>CBO</sub> : 32 V	P : 0,1 W Ta : 45 °C		: > 20	3	10	
AF202S	TQ-72LR	1	łC :30 mA	Tj : 90 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	Yfe	: 95 mS	3	10	35
AF239	PNP	Ampl. RF oscill, conv. UHF	V <sub>CEO</sub> : 15 V V <sub>CBO</sub> : 20 V	P : 60 mW T <sub>a</sub> : 45 °C	Yfb	: 33 . 20 mS	2 2	10	800
AL 239	TO - 72	fino a 890 MHz	IC : 10 mA	τ <sub>j</sub> : 90 °C	G <sub>U!</sub>	M : 17 dB . 650 MHz	2	10	800
AF239\$	PNP TO-72		Impiego e dati teo	nici come AF239 eccett		: 15 dB : 780 MHz	2 2	10 10	800
AF240	PNP	Ampl. RF oscill. VHF-UHF	V <sub>CEO</sub> : 15 V V <sub>CBO</sub>   20 V	P : 60 mW Ta : 45 °C	Gtr	: 25 : 14 dB	2	10	800
	TO - 72		I <sub>C</sub> : 10 mA	Tj : 90 °C	f <sub>T</sub>	: 650 MHz		10	
AF251	PNP MM - 12	Ampi. RF per UHF	VCEO : 15 V VCBO : 20 V IC : 10 mA	P : 90 mW T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>i</sub> : 90 °C	h£€ <sup>f</sup> ⊤	: : 30 : 750 MHz	2	12 12	

	CONT.	IMPLEGO	(T <sub>a</sub> = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE a (Ta = 25 °C)			f {MHz
	PNP	Oscill, conv. UHF	VCEO : 15 V	P : 90 mW	hFE : > 10	2	12	
AF262			VCBO : 20 V	Ta : 45 °C	fr : 650 MHz "	2	12	
	MM - 12 A		I <sub>C</sub> : 10 mA	T <sub>1</sub> : 90 °C				
	PNP	Ampl. RF per UHF	V <sub>CEO</sub> : 15 V	P : 90 mW	hFE : > 10	2	12	
AF253			VCBO : 20 V	Ta : 45 °C	f <sub>T</sub> : 550 MHz	2	12	
	MM - 12 A		I <sub>C</sub> : 10 mA	Tj : 90 °C				
	PNP	Ampl. RF	VCEO : 18 V	P = 90 mW	hFE: 28	1	12	
AF256		oscill, VHF	VCBO : 25 V	Ta : 45 °C	f <sub>T</sub> :>170 MHz	1	12	
	MM - 12A		IC : 10 mA	T  : 90 °C	γ <sub>fb</sub> . 14 mS	1,5		
	PNP	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 15 V	P : 60 mW	hFE : 50	2	10	
AF279		oscill, UHF	VCBO : 20 V	Ta:55 °C	fF : 780 MHz	2	10	
	TO - 50		t <sub>C</sub> : 10 mA	Tj : 90 °C				
	PNP	Ampl. RF	VCEO : 15 V	P : 60 mW	hFE : 25	2	10	
AF280		oscill, UHF	VCBO : 20 V	Ta : 55 °C	f <sub>T</sub> : 550 MHz	2	10	
	TO-50		IC : 10 mA	Tj : 90 °C	G <sub>tr</sub> : 12 dB	2	10	800
	PNP	Ampl. RF	V <sub>CBO</sub> : 12 V	P : 112 mW	hee: 25 - 120	1	12	
AFY12	rive	oscill. VHF	IC : 10 mA	T <sub>C</sub> : 45 °C	f <sub>T</sub> : 230 MHz			
MF 7 12	TO - 72	OSCINE VIII	10 . 10 mm	Ti : 90 °C	1			
		A DE 11116	)( 20 V	P ; 112 mW	hee : > 10	1,5	12	_
4 CV 4 F	PNP	Ampl. RF per UHF	V <sub>CBO</sub> . 30° V Ic : 10° mA	T <sub>C</sub> : 45 °C	1 : 550 MHz	.,.		
AFY16	TO - 72		ic itima	T <sub>i</sub> : 90 °C	. 555			
				P : 50 W	bFE: 40-250	1000	1	
	PNP	Commutazione	VCEO : 40 V	T <sub>c</sub> : 25 °C	f <sub>T</sub> : 7,5 MHz	1000	1	
AL100	TO-3	alta velocità	VCBO : 100 V	T <sub>j</sub> 100 °C	1 17,5 11112	, 200	Ĺ	
	PNP	Commutazione	Vara : 40 V	P : 50 W	hFE : 40-250	1000	1	
AL101	PNP	alta velocità	VCEO : 40 V VCBO : 60 V	T <sub>c</sub> : 25 °C	f <sub>T</sub> : 7,5 MHz	1000	1	
ALIVI	TO-3	BIGS SCIOCITS	IC : 10 A	Tj:100 °C	11			
					har 40 350	1000	1	
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 50 V	P : 12,5 W	hfg: 40-250 β : 150	1000	1	
AL102	TO-3	Commutazione	V <sub>CBO</sub> . 75 V IC : 5 A	T <sub>C</sub> : 81 °C T;: 100 °C	β : 150 f <sub>T</sub> : 4 MHz	.000		
				.,, .	•			
	PNP	Ampl. finale BF	VCEO : 40 V	P : 12,5 W	hFE: 40 - 250	1000	1	
AL103		Commutazione	VCBO : 60 V	T <sub>C</sub> : 81 °C	β : 80	1000	1	
	TO-3		IC : 5 A	T; : 100 °C	f <sub>T</sub> : 3 MHz			
	PNP	Ampl, di potenza	VCEO : 60 V	P : 10 W	hFE: 30 - 180	500	2	
AL112		Commutazione	VCBO : 130 V	T <sub>c</sub> : 60 °C	f <sub>T</sub> : 3 MHz			
	SOT-9		IC : 6 A	т; : 100 °С				
	PNP	Ampl. di potenza	VCEO : 40 V	P : 10 W	hpg: 40 - 180	500	2	
AL113	SOT-9	Commutazione	VCBO: 100 V IC: 6 A	T <sub>C</sub> : 60 °C T <sub>j</sub> : 100 °C	f <sub>T</sub> : 3 MHz			
				- <del></del>	he= : > 20	20	- 1	
	PNP	Commutazione	VCED : 15 V	P:0,15 W T;:85 °C	h¢E:>30 f <sub>T</sub> : ΒMHz	3		
ASY26			VCBO: 30 V Ic: 0,2 A	R <sub>the</sub> : 200 °C/W	ton : 340 ns		-	
	TO-5			THE . LOS OF IT	toff : 975 ns			

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS		CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a Ic (mA)	<b>V</b> çı (V)
<b>4</b> \$¥27	PNP .		Impiego e dati tecn VCBO : 25 V	iici come ASY26 eccetto	h <sub>FE</sub> :>50 f <sub>T</sub> : 14 MHz t <sub>on</sub> : 250 ns	20	1 5
	TO - 5				t <sub>off</sub> : 1000 ns		
	NPN	Commutazione	V <sub>CEO</sub> : 15 V	P : 0,15 W	hFE : > 30	20	1
ASY28	<b>TO</b> 5		V <sub>СВО</sub> : 30 V I <sub>С</sub> : 0,2 A	Tj 85 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	f <sub>T</sub> : 14 MHz t <sub>OD</sub> : 225 ns	3	5
	TO-5				t <sub>off</sub> : 775 ns		
	NPN		Impiego e dati tecn VCBO : 25 V	rici come ASY28 eccetto	t heE:>50 fT: 20 MHz	20 3	1 5
ASY29	TO-5		CBO		t <sub>on</sub> : 185 ns t <sub>off</sub> : 800 ns	Ť	Ť
	NPN			D 0.4411	- * .		<del></del>
<b>4SY75</b>	NPN	Commutazione	VCEO : 15 V VCBO : 30 V	P : 0,14 W T; : 75 °C	hF€ : >50 fT : 10 MHz	200 3	1 5
	TO-5		€C : 0,4 A	R <sub>the</sub> : 200 °C/W			
	PNP	Commutazione	VCEO : 60 V	P : 30 W	hFE: 20 - 55	1900	1
ASZ15		Circuiti alim.	V <sub>CBO</sub> : 100 V	T <sub>C</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 90 °C	f <sub>T</sub> : 0,2 MHz	1000	5
	10-3			R <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W			
	PNP	Commutazione	VCEO : 32 V	P : 30 W	hFE: 45 - 130	1000 1000	1 5
ASZ16		Circuiti aliin.	VCBO: 60 V	1c : 45 °C Tj : 90 °C	f <sub>T</sub> : 0,25 MHz	1000	Ş
	TO - 3			R <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W			
ASZ 17	PNP		Impiego e dati tecr	nici come ASZ16 eccetto		1000	1 5
	TO-3				f <sub>T</sub> : 0,22 MHz	1000	
4SZ18	PNP			nici come ASZ17 eccetto	: h <sub>FE</sub> : 30 - 110	1000	1
	TO-3		V <sub>CBO</sub> : 100 V				_
	PNP	Ampl. uscita	VCEO : 120 V	P : 10 W T <sub>C</sub> : 70 °C	hee : 12 · 50 f <sub>T</sub> : > 0,4 MHz	10 A 500	2
AU101		orizz. TV	V <sub>CBO</sub> : 120 V Ic : 10 A	Tj : 90 °C	1 . > 0,4 101112	,00	-
	TO-3			R <sub>thc</sub> : 2 °C/W			
	PNP	Deflessione	V <sub>CEX</sub> : 155 V	P : 10 W	hpE : > 15	10 A	2
AU103		prizz, TV	V <sub>CBO</sub> : 155 V IC : 10 A	T <sub>C</sub> : 75 °C T <sub>j</sub> : 90 °C	f <sub>T</sub> : 15 MHz	600	2
	TO-3		10 . 10 %	Rthc: 1,5 °C/W			
	PNP	Deflessione	V <sub>CEX</sub> : 185 V	P : 15 W	h <sub>FE</sub> : > 15	10 A	1
AU104		orizz. TV	V <sub>CBO</sub> : 185 V I <sub>C</sub> : 12 A	T <sub>C</sub> : 67,5 °C T <sub>i</sub> : 90 °C	f <sub>T</sub> : 15 MHz	500	2
	TO-3		10 . 12.4	R <sub>thc</sub> : 1,5 °C/W	<u></u>		
- ***	PNP	Deflessione	V <sub>C8O</sub> : 320 V	P : 23 W	hFE: 15 - 80	6000	1,3
AU106		or zz. TV	IC : 10 A	T <sub>C</sub> : 55 °C	fT : 2 MHz		
AU106	TO-3	orizz, TV	IC : 10 A	T <sub>i</sub> : 90 °C	(1 : 5 MISS		

SIGLA	TIPO e CONT.	(MPIEGO	VALORI MASS (T <sub>B</sub> = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE	a (mA)	V <sub>CI</sub>
411403	PNP	Deflessione	V <sub>CBO</sub> : 200 V	P : 30 W	hpg : 35 - 120	700	2
AU107	TO - 3	vert. TV	<sup>1</sup> C : 10 A	T <sub>C</sub> : 45 °C T <sub>J</sub> : 90 °C	f <sub>T</sub> : 2 MHz		
AU108	PNP	Deflessione orizz, TV	V <sub>CBO</sub> : 100 V	P 30 W T <sub>c</sub> : 45 °C	hpg: 35 - 200	700	2
-0100	TQ -3	0.22, 17		T <sub>i</sub> : 90 °C			
	PNP	Deflessione	V <sub>CBO</sub> 100 V	P 30 W	h#£ . 120 • 250	1000	2
AU108F	TO - 3	orizz. TV	IC . 10 A	T <sub>C</sub> 45 °C T <sub>1</sub> 90 °C			
	PNP	Ampl, finale TV	V <sub>C9</sub> O 160 V	P 30 W	PE . 50 - 80	1000	2
AU110	10 - 3		1 <sub>C</sub> 10 A	T <sub>C</sub> 55 °C T <sub>I</sub> 100 °C			
	PNP	Deflessione	VCBO 320 V	P 23 W	hFE . 15 · 80	6000	1,3
AU171	TQ - 3	orizz. TV	IC . 10 A	Т <sub>С</sub> . 55 °С Тј 90 °С	f <sub>T</sub> : 2 MH≥		
	PNP	Deflessione	V <sub>CBO</sub> . 320 V	P : 23 W	hFE : 15 - 40	600 <b>0</b>	1,3
AU112	TO-3	orizz TV	1C 10 A	T <sub>C</sub> : 55 °C T <sub>j</sub> : 90 °C	† <sub>T</sub> : 2 MHz		
	PNP	Deflessione	V <sub>CBO</sub> 250 V	P : 23 W	hgE : 15 - 80	600 <b>0</b>	1,3
AU113	TO - 3	arizz TV	IC : 10 A	T <sub>C</sub> : 55 °C T <sub>I</sub> : 90 °C			
	NPN	Preampt e	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P 0,3 W		: 220 2	5
BC107	TQ - 18	pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 50 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>1hc</sub> 200 °C/W	B hFE : 290 β f <sub>T</sub> : 300 MHz	: 330 2 10	5 5
	NPN	Preampl, it	VCEO 20 V	P : 0,3 W	A hFE 180 β		5
BC108		pilota BF	V <sub>C80</sub> 30 V IC 0,1 A	T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	B h <sub>FE</sub> 290 β: C h <sub>FE</sub> 520 β:		5 5
	TO - 18				1 <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	NPN	Preampl BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P 0,3 W	B h <sub>FF</sub> : 290 β : C h <sub>FE</sub> : 520 β :		5 5
8C129	TO - 18	basso rumore	V <sub>CBO</sub> 30 V	Tj : 175 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	1 <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	NPN	Ampl. BF	VCEO 80 V	P : 03W	hFE: > 30	2	5
BC110	TO 18	uso generale	V <sub>CBO</sub> : 80 V I <sub>C</sub> . 50 mA	T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>tho</sub> : 200 °C/W	f <sub>T</sub> . 100 MHz	10	5
	NPN	Preampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,2 W	hpg : 350	1	5
BC113	TO - 106	ap	VCBO : 30 V	T <sub>I</sub> : 125 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	β : 350 f <sub>T</sub> : 60 MHz	1	5
BC114	NPN TO-106	Preampl. 8F basso rumore	Dati tecnici come				-
	NPN	Preampt. e	ν <sub>CEO</sub> . 30 ν	P : 0,3 W	hFE : 145	1	10
8C115	TO - 105	pilota BF	V <sub>CBO</sub> . 40 V I <sub>C</sub> : 0,2 A	T <sub>j</sub> : 125 °C R <sub>thc</sub> : 125 °C/W	eta=:370 1 $_{T}=:$ 40 MHz	10	10

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS	SIMI	CARAT (Ta	TERISTICHE : , = 25 °C)		V <sub>CE</sub> (V)	f (MHz
	PNP	Impiego generale	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 0,3 W		hբę : 100	10	1	
BC118			VC80 : 45 V	T; : 125 °C		β 2	30	10	100
	TO - 105		IC : 0,6 A	R <sub>thc</sub> : 125 °C/W		f <sub>T</sub> : 200 MHz			
	NPN	Impiego generale	V <sub>CEO</sub> : 120 V	P : 0,3 W		hFE : 50	10	10	
BC117	TO-105	alta tensione	V <sub>CBO</sub> : 120 V	Tj : 125 °C R <sub>thc</sub> : 125 °C/W		β : 50 f <sub>T</sub> : 40 MHz	10	5	
	NPN	Impiego generale	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 0,2 W		hFE: 40 - 160	10	10	
BC118			VCBO : 45 V	T <sub>i</sub> : 125 °C		β : 3,5	10	15	100
	TO - 106			R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	_	f <sub>T</sub> : 350 MHz			
	NPN	Ampl. uscita BF	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,8 W		hFE: 100	50	1	
BC119			V <sub>CBO</sub> : 60 V	τ <sub>j</sub> : 200 °C		ß :>2	50	10	20
	TO - 39			R <sub>thc</sub> : 35 °C/W					
	NPN	Pilota orizz, e	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,8 W		hFE:70	10	10	20
BC120		vert. TV	V <sub>CBO</sub> : 60 V	Tj : 200 °C		β :>2	50	10	20
	TO - 39			R <sub>thc</sub> : 58,3 °C		1 <sub>T</sub> : 40 MHz			
	NPN	Ampl. pilota BF	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,3 W		hFE : 50	1	1	
BC125		compl. BC126	VCBO : 50 V	τ <sub>j</sub> : 125 °C		β :>2	50	10	20
	TO - 105		IC : 0,6 A	R <sub>thg</sub> : 125 °C/W		<sup>1</sup> T : 40 MHz			
BC126	PNP	Ampl, pilota BF	Dati tecnici come	BC125 eccetto:		hFE : 62	1	1	
	TO - 105	compl. BC125	V <sub>CBO</sub> : 35 V			f <sub>T</sub> : 200 MHz			
	NPN	Ampl. pilota 8F	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 135 mW		hFE : 220	2	5	
BC129		basso rumore	VCBO : 50 V	T <sub>a</sub> : 45 °C		β : 125 - 260	2	5 5	
00125	TO - 18		IC : 0,1 A	τ <sub>j</sub> : 175 °C	8	β : 240 - 500 f <sub>T</sub> : 300 MHz	2 10	5	
	NPN	Ampl. pilota BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 135 mW		hFE: 220	2	5	
		basso rumore	V <sub>CBO</sub> : 30 V	Ta: 45 °C		β : 125 - 260	2	5	
BC130			IC : 0,1 A	Tj : 175 °C		β : 240 - 500	2	5 5	
	TO - 18					β : 470 - 900 f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5	
	NPN	<del></del> -	Impiego e dati te	onici come BC130 eccetto	1:'	hFE: 400	2		
BC131	141.14		improge a data to		В	β : 240 - 500	2	5	
56161	TO - 18				c	β : 470 - 900	2	5	
	NPN	Ampl. BF	v <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,2 W		hFE : 220	t	10	
BC132			V <sub>CBO</sub> : 30 V	Tj : 125 °C		β : 240	,	- 5	
	TO - 106	_		R <sub>the</sub> : 200 PC/W	_	f <sub>Υ</sub> : 40 MHz			
	NPN	Implego generale	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 0,2 W		hFE : 250	10	10	
BC134	TO 100		V <sub>C8O</sub> : 45 V	T <sub>j</sub> : 125 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W		β : 230 f <sub>T</sub> : 350 MHz	5	10	
***	TÓ - 106			Tithe 200 C/31		.1 . 200			
	PNP	Ampl. uscita BF	V <sub>GEO</sub> : 40 V	P : 0,7 W		hFE: 90	10	10	***
BC139			V <sub>CBO</sub> : 40 V	T <sub>j</sub> : 200 °C		β : 2	50	10	100
	TO - 39		IC : 0,5 A	R <sub>thc</sub> : 58,3 °C/W		fT : 40 MHz			

## DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	CONT.	IMPLEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C)			TTERISTICHE a = 25 °C)	a fc (mA)	V <sub>CE</sub> (V)
BC140	NPN	Ampl, BF basso rumora commut. rapida	VCEO : 40 V VCBO : 80 V IC : 1 A	P : 3,7 W T <sub>C</sub> : 45 °C T <sub>i</sub> : 175 °C	10	hFE: 40 - 100 hFE: 63 - 160 hFE: 100 - 250	100 100 100	
	TO - 39	com.rat. repide	IC . IA	R <sub>tha</sub> : 220 °C/W	••	f <sub>T</sub> :>60	50	10
BC141	NPN			nici come BC140 ecce	tto:			
	TO - 39		VCEO : 60 V					
BC142	NPN	Ampl. pilota ed uscita BF	V <sub>CEO</sub> : 60 V V <sub>CBO</sub> : 70 V	P:0,8 W		hFE: 80 f <sub>T</sub> : 40 MHz	200	
	TO - 5	compl. BC143						
BC143	PNP	Ampl, pilota ed uscita BF	V <sub>CEO</sub> : 60 V V <sub>CBO</sub> : 60 V	P : 0,8 W		hFE: 70 f <sub>T</sub> : 100 MHz	200	
	TO - 5	compl. BC142						
BC144	NPN TO - 5	Ampl. pilota ed uscita BF compl. BC139	V <sub>CEO</sub> : 40 V V <sub>CBO</sub> : 60 V	P:0,8 W		hpe : 40 f <sub>T</sub> : 40 MHz	300	
	NPN	Ampi. pilota BF	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 0,25 W		hFE: 180 β:		5
BC147	SOT - 25 MM - 12	compl. BC157	V <sub>CBO</sub> : 50 V	Τ <sub>j</sub> : 125 <sup>©</sup> C	8	h <sub>FE</sub> : 290 β: f <sub>T</sub> : 300 MHz	>240 2 10	<b>6</b> 5
	NPN	Preampt, e pilota BF	VCEO : 20 V VCBO : 30 V	P: 0,25 W Ti: 125 °C		hFE: 180 β: hFE: 290 β:	>125 2 >240 2	5
BC148	SOT - 25 MM - 12		IC : 0,1 A	17 . 120 0			>470 2	5
BC149	NPN SOT - 25 MM - 12	Preampl. BF basso rumore compl. BC159	VCEO : 20 V VCBO : 30 V IC : 0,1 A	P : 0,25 W T <sub>j</sub> : 125 °C		hFE: 290 β: hFE: 520 β: f <sub>T</sub> : 300 MHz	>240 2 >470 2 10	5 5 5
	PNP	Preampl. e	VCEO : 40 V	P : 0,2 W		hpg : 135	1	5
BC153	TO - 106	pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 40 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	Tj : 125 °C Rthc : 200 °C/W		β : 135 f <sub>T</sub> : 40 MHz	1	5
BC154	PNP	Preampl. BF alto guadagno	Dati tecnici come	BC153 eccetto:		hFE: 230 β: 230	1 1	5 6
	TO - 106	basso rumora				F . 200		
	NPN .	Ampl. BF	VCEO: 5 V	P : 105 mW		β: 85 - 220 β: 200 - 500	0,5 0,5	1
BC166			VCBO: 5 V Ic: :50 mA	T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 125 °C		β: 470 - 900	0,5	1
	TOM - 13					f <sub>T</sub> :>50 MHz	2	
BC156	NPN TOM - 23	Ampl. BF	VCEO : 5 V VCBO : 5 V IC : 50 mA	P: 50 mW Ta: 45 °C Tj: 125 °C	В	$\beta$ : 85 - 220 $\beta$ : 200 - 500 $\beta$ : 470 - 900 $f_T$ : > 50 MHz	0,5 0,5 0,5 2	1 1 1 5
 8C157	PNP SOT - 25	Ampl. pilota BF compl. BC147	VCEO : 45 V VCBO : 50 V	P:0,25 W T <sub>i</sub> : 125 °C		hpg: 140 β: 3	> 75 2	5 5

## (47 RSTT)

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MA			ATTERISTICHE 8 T <sub>a</sub> = 25 °C)	lc (mA)	V <sub>C</sub>
		_						-
	PNP	Preampl, e	VCEQ : 25 V	P : 0,25 W	VI	hFE: 140 β:> 75	2	5
BC158		pitota BF	V <sub>CBO</sub> : 30 V	Tj: 125 °C	Α	hFE: 180 β:>125	2	5
	SOT - 25	compl. BC148	IC : 0,1 A		В	hFE:290 β:>240	2	5
	MM - 12	1			_	f <sub>T</sub> : 150 MHz	10	5
	PNP	Preempl, BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,25 W	A	hpg: 180 β:>125	2	5
BC159	SOT-25	basso rumore	VCBO: 25 V	Tj : 125 °C	В	hFE: 290 β:>240	2	5
	MM - 12	compl. BC149	lc : 0,1 A			f <sub>T</sub> : 150 MHz	10	5
	NPN	Preampl. e	VCEO : 45 V	P : 0,22 W		hpg : 220	2	5
BC167		pilota BF	VCBO : 50 V	Ti : 125 °C	Α	β : 125 - 260	2	5
DC 107	TO-92B	basso rumore	lc : 0,1 A	,	В	β : 240 - 500	2	5
	MM-118	compl. BC257				f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	NPN	Preempl. e	VCEO : 20 V	P : 0,22 W		hpg : 220		5
		pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 30 V	Ti : 125 °C	А	β : 125 - 260	2	5
BC168		basso rumore	(c : 0,1 A	.1 - 120 0	В	β : 240 - 500	2	5
	TO - 928	compl. BC158			C	β : 470 - 900	2	5
	MM-11B				·	f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	NPN	Preempl, e	Dati tecnici come	PC169 constant		t : 100	2	5
		pilota BF		DOTOD GOOTIO.	В	hFE: 400	_	-
BC169	TO-928	basso rumore			C	β : 240 - 500 β : 470 - 900	2	5
	MM-118	compl. BC259			L	β : 470 - 900	2	5
	NPN	Ampl. RF-FI	VCEO : 20 V	P : 0,2 W		hpE: 36 - 100	1	•
		per AM - OC	*CEO . 20 *				i	
BC170		Commutazione				hpg : 35 - 100	•	
DU 17U		Commutazione			В		1	
					С		1	
	TO - 92			~ ~		f <sub>T</sub> : 100 MHz		
	NPN	Ampl. RF - FI	VCEO : 45 V	P:0,2 W		hFE : 275	2	. •
3C171		per AM-OC				hFE : 225	20	
					В	hFE: 350	20	
	TO -92					f <sub>T</sub> : 300 MHz		
	NPN	Ampl, RF-FI	VCEO : 20 V	P : 0,2 W		hpE : 225	20	
		per AM - OC			Α	hFE: 225	20	
3C172					В	hFE : 350	20	
					С	hpg : 620	20	
	TO-92					f <sub>T</sub> : 300 MHz		
,	PNP	Preampl. e	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 0,3 W	v	hpg: 75 β:> 50	2	5
		pilota BF	VCBO: 50 V	T; : 175 °C	VI	h <sub>FE</sub> : 140 β:> 75	2	5
3C177		compl. BC107	IC : 0,1 A	Rthe : 200 °C/W	A	heE: 180 β:>125	2	5
				THE TOTAL STREET		hFE: 290 β: >240	2	5
	TO-18					f <sub>T</sub> : 130 MHz	10	5
	PNP	Presmpl, e	Dati tecnici come	BC177 eccetto:			-	
BC178		pilota BF	VCEO : 25 V					
	TO - 1B	compl. BC108	VC80 : 30 V					
	PNP	Preampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,3 W	А	heE: 180 β:>125	2	5
3C179		basso rumore	VCBO : 25 V	Tj : 175 °C		hFE: 290 β:>240	2	5
	TO - 18	compl. BC109	Ic : 0,1 A	R <sub>thc</sub> : 200 °C/W		t <sub>T</sub> : 130 MHz	10	5

SIGLA	CONT,	IMPIEGO	VALORI MAS IT <sub>a</sub> = 25 °C			TTERISTICHE a a = 25 °C)	Ic ImA)	V <sub>C</sub> (V
BÇ183	NPN TO - 1B	Ampl. RF - MF	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P 10,3 W		hFE . < 85 f <sub>T</sub> : 150 MHz	2	
	NPN	Applicazioni	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,1 W		hpe:> 25	1	10
BC194	TOM-13	generali RF Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 40 V I <sub>C</sub> : 0,8 A	T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> :125 °C		f <sub>T</sub> : > 250 MHz	20	10
	NPN	Impiego	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 50 mW		hFE : 220	2	5
3C197		generale BF	VCBO : 50 V	Ta: 45 °C	A	$\beta$ : 125 - 260	2	5
aC 197		•	IC : 0,1 A	Tj : 125 °C	В	$\beta$ : 240 - 500	2	5
	TOM- 23					f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	NPN	,	Impiego e dati ter	mici come BC197 ecceti	to: A	β:125 - 260	2	5
3C198			VCEO: 20 V		8	$\beta$ : 240 - 500	2	5
JU 100			VCBO: 30 V		c	β : 470 - 900	2	5
	TOM-23					f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	NPN	Impiego	VCEO: 20 V	P : 50 mW		hFE: 400	2	5
BC199		generale BF	VCBO: 30 V	Ta: 45 °C		β : 240 - 500	2	5
	TOM-23		I <sub>C</sub> : 0,1 A	Tj : 125 °C	С	β : 470 - 900 f <sub>T</sub> : 300 MHz	2 10	5 5
						·		
	PNP	Preampl, e	VCEO: 45 V	P : 0,3 W	٧		2	5
		pilota BF	VCBO : 45 V	T <sub>j</sub> · 125 °C		heε: 110 β:> 75	2	5
3C204	TO-92		IC : 0,1 A			hpe: 180 β:>125	2	5 5
	TO - 106 RO - 110				В	hpE: 290 β:>240 f <sub>T</sub> : 200 MHz	2 10	5
	PNP	Preampl. e	Oati tecnici come	BC204 eccetto:				
BC205	TO-92	pilota BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V					
	TO - 106 RO - 110		V <sub>CBO</sub> : 20 V					
	PNP	Preampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,3 W	В	hFE: 290	2	5
BC206	TO-92	basso rumore	V <sub>CBO</sub> : 20 V	Tj: 125 °C		β :>240	2	5
50200	TO - 106 RO - 110		IC : 0,1 A			f <sub>T</sub> : 200 MHz	10	5
	NPN	Preampt, e	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P: 0,3 W	Α	hFE: 180 β: 200	2	5
BC207	TO-92	pilota BF	VCBO: 45 V	Tj : 125 °C	В	hFE: 290 β: 330	2	5
06207	TO-106		IC : 0,1 A			$\beta$ : 200 - 330	2	5
	RO-110			·		f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	
	NPN	Preampl. e	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,3 W		hFE: 180 β: 200	2	5
BC208	TO -92	pilota BF	VCBO : 20 V	τ <sub>j</sub> : 125 °C		hFE:290 β:330	2	5 5
	TO-106		IC : 0,1 A		C	hpe: 520 β: 600 f <sub>T</sub> : 300 MHz	2 10	5.
	RO-110					-1 . 300 MHz	10	
	NPN	Preampl, BF	VCEQ : 20 V	P : 0,3 W	В	h <sub>FE</sub> : 290 β: 330 h <sub>FE</sub> : 520 β: 600	2 2	5 5
3C209	TO-92	basso rumore	V <sub>CBO</sub> : 20 V	Tj : 125 °C	U	f <sub>T</sub> : 300 MHz	10	5
	TO-106 RO-110		IC : 0,1 A			1 . 300 10112	,,,	•
	NPN	Pilota orizz, e	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,45 W		hFE: 30 - 140	10	1
		vert. TV	VCBO : 50 V	T; : 175 °C		fT : 250 MHz	20	10
BC210			IC : 0,7 A	R <sub>thc</sub> : 100 °C/W		ton : 30 ns	150	
	TO - 1B		-			t <sub>off</sub> : 180 ns	150	

SIGLA	TIPO B CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS	SIMI		TTERISTICHE a a = 25 °C)	I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CE</sub>
	NPN	Pilota orizz. e	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,6 W		hFE: 30 - 140	10	1
BC210A		vert. TV	VCBO : 50 V	Tj : 175 °C		f <sub>T</sub> : 250 MHz	20	10
	TO-5		Ic : 0,7 A	R <sub>thc</sub> : 60 °C/W		ton : 30 ns toff : 180 ns	150 150	
	NPN	Pilota orizz, e	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 0,8 W		hFE: 70	10	1
BC211		vert. TV	VCBO : 80 V	τ <sub>j</sub> : 175 °C		f <sub>T</sub> : 200 MHz	50	10
50211	TO-5		IC : 1 A	R <sub>thc</sub> : 35 °C/W		t <sub>on</sub> ; 340 ns t <sub>off</sub> : 180 ns	150 150	
BOOAT.	PNP	Implega generale	VCEO : 30 V	P : 0,4 W		hpg: 40 - 120	150 150	10 10
BC215	TO- 18		V <sub>CBO</sub> = 50 V I <sub>C</sub> = 0,5 A	T <sub>i</sub> : 200 °C R <sub>thc</sub> : 140 °C/W		hpE: 100 - 300 f <sub>T</sub> : 200 MHz	30	10
	PNP	Preampl, e	VCEO: 40 V	P : 0,2 W		hFE : J70	1	5
BC225		pilota BF	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C		β : 185	1	5
	TO-106		IC : 0,1 A	R <sub>thc</sub> : 200 °C/W				
	NPN	Impiego generale	V <sub>CBO</sub> : 120 V	P : 0,3 W		hFE: >25	10	10
8C236	RO - 110	alta tensione	IC : 50 mA	Tj : 125 °C		β :>25	10	5
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BC147 eccet	ito:			
BC237	TO -92 MM - 11			P:0,3 W				
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BC148 eccet	ito:			
BC238	TO -92 MM - 11			P:0,3 W				
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BC149 eccel	tto:			
BC239	TO - 92 MM - 11			P:0,3 W				
	PNP	Preampl_ e	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 0,22 W		h <sub>FE</sub> : 110 β:> 75	2	
BC <b>257</b>		pilota BF	VCBO : 50 V	Tj : 125 °C	Α	hFE: 180 β:>125	2	_
	TO-92B	compi. BC167	IC : 0,1 A	<u> </u>		f <sub>T</sub> : 130 MHz	10	
	PNP	Preampl. e	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,22 W		hpg: 110 β: > 76	2	
BC258		pilota BF	ACBO : 30 A	Tj: 125 °C	A B	hFE: 180 $\beta$ : > 125 hFE: 290 $\beta$ : > 240	2	
	TO-92B	compi, BC168	1 <sub>C</sub> : 0,1 A		ů	f <sub>T</sub> : 130 MHz	10	5
	,		V 20 V	P : 0,22 W	Δ	hFE:180 β:>125	2	
BC259	PNP	Preampt. e pilota BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V V <sub>CBO</sub> : 25 V	T <sub>i</sub> : 125 °C	В	hFE: 290 β:>240	2	
00200	TO-92B	compl. BC169	Ic : 0,1 A	,		J <sub>T</sub> : 130 MHz	10	5
	NPN	Ampl. pilota BF	VCEO : 45 V	P : 0,375 W		β:125 - 500	2	5
BC267	TO - 18	Commutazione	VCBO : 50 V IC : 0,5 A	Tj : 175 °C		f <sub>T</sub> : 200 MHz		
				D . 0.375 W		β : 125 - 900	2	
	NPN	Ampl. pilota BF	VCEO : 20 V	P:0,375 W Tj: 175 °C		β: 125 - 900 f <sub>T</sub> : 200 MHz	2	,
BC268	TO - 18	alto guadagno Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 30 V I <sub>C</sub> : 0,5 A	η. 125.0				
	NPN	Preampl, BF						
BC269		basso rumore	Oati tecnici come	BC268 eccetto:		β : 240 - 900	2	5
	TO - 1B	Commutazione						

IGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T <sub>a</sub> = 25 °C)	IMI		TTERISTIC a = 25 °C)	HE B	lg (mA)	<b>V</b> ct (V)
IÇ270	NPN	Ampl. pilota BF	Dati tecnici come	BC268 eccetto:		β:50-90	)	2	5
QE/O	TO -18	Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 20 V						
	NPN	Preampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 0,36 W	A	hFE: 200	β: 220	1	5
C280		basso rumore	VCBO : 45 V	Tj : 200 °C	B-C	hFE ; 350	β: 370	1	5
-	TO - 18		IC : 0,1 A .	R <sub>thc</sub> : 146 °C/W					
1	PNP	Preampl. BF	VCEO : 45 V	P : 0,36 W	Α	hpg : 120	β: 130	1	5
BC281		basso rumore	VCBO : 45 V	Tj : 200 °C	В	h <sub>FE</sub> : 200	β . 200	1	5
	TQ - 18		I <sub>C</sub> : 0,2 A	Rthc: 146 °C/W	С	heE : 250	β: 250	1	5
	NPN	Ampl. pilota e	VCEO : 30 V	P ; 0,4 W		hFE : 150		50	6
BC282		finale BF	VCBO : 60 V	Tj : 200 °C		β : 170		50	6
	TO - 18	compl. BC283	IC : 0,6 A	Rthc: 134 °C/W					
	PNP	Ampl, pilota e	VCEO : 30 V	P : 0,4 W		hFE : 130		50	5
BC283	4 141	finale BF	VCBO : 30 V	T <sub>i</sub> : 200 °C		β : 110		50	5
	TO-18	compl, BC282	IC : 0,6 A	R <sub>thc</sub> : 134 °C/W					
	NPN	Ampl, pilota BF	VCEO : 40 V	P : 0,5 W	А	hFE: 230	β: 265	10	10
BC284	141.14	, unpe, priore of	VCBO : 40 V	Tj : 200 °C	В	hpg : 350	β: 390	10	10
	TO - 18		IC : 0,2 A	R <sub>thc</sub> : 97 °C/W		_			
	NPN	Preampl. 6	VCEO : 120 V	P : 0,36 W		hFE : 70		5	30
BC285	***	pifota BF	VCBO : 120 V	Tj : 200 °C		β : 70		6	30
DOLLOG	TO-18	alta tensione	IC : 0,1 A	R <sub>thc</sub> : 146 °C/W					
	NPN	Ampl. uscita BF	VCER : 60 V	P : 0,8 W		hFE : 170		10	2
			(RBE : $<$ 200 $\Omega$	) T <sub>j</sub> : 200 °C		β : 120		1 1 1 1 1 1 50 50 50 50	-
BC288			V <sub>CBO</sub> : 70 V	R <sub>thc</sub> : 43,7 °C/W					
	10-39		IC : 1 A						
	PNP	Ampl, uscita 8F	VCEO : 60 V	P : 0,8 W		hFE : 90			2
BC287			VCBO : 60 V	Tj : 200 °C		β : 90		100	-
	TO - 39		IC : 1 A	Rthc : 43,7 °C/W					
	NPN	Ampl, uscita BF	VCEO : 40 V	P : 0,8 A		hFE : 150			2
BC288			VC80 : 80 V	Tj : 200 °C		β : 145	'	500	•
	TO-39		Ic : 5 A	R <sub>thc</sub> : 25 °C/W					
	PNP	Ampl. pitota o	V <sub>CEO</sub> : 45 V	P : 0,376 W		hpg : 75		100	1
BC297		finate BF	VCBO : 50 V	τ <sub>j</sub> ; 175 °C		fT : 150	MITIE		
	TO-18	Commutazione	Ic : 1 A						
	PNP	Ampl. pilota o	V <sub>CEO</sub> ; 25 V	P : 0,375 W		hFE: 75	5 - 500 MHz	100	1
BC298		finale BF	V <sub>CBO</sub> : 30 V	τ <sub>j</sub> : 175 °C		,,			
	TQ-18	Commutezione	lc : 1 A						
	NPN	Ampl. pilota BF	VCEO : 80 V	P ; 6 W T <sub>C</sub> : 25 °C		hpg : 40 f <sub>T</sub> : 120		150	10
BC300	TO - 39	Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 120 V I <sub>C</sub> : 0,5 A	1c: 25 °C Tj: 175 °C		-1 -1-			
				ecnici come BC300 eco	etto:				
0.0004	MPN		Implego a dati te VCEO : 60 V	TOTAL COMP BLOOD CC					
BC301	TO - 39		VCBO : 90 V						

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	IMI		TERISTICHE	a	1 <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CI</sub>
3C3 <b>O2</b>	NPN		Impiego e dati tecn VCEO : 45 V	: ic: come BC300 eccetto	:				
	TO - 39		VCBO : 60 V						
BC303	PNP		Impiego e dati tecn VCEO : 60 V	nici come BC300 eccetto		t <sub>T</sub> : 75 MHz			
	TO - 39		VCBO : 85 V						
	PN₽		Impiego e dati tecr	nici come BC300 eccetto		t <sub>T</sub> : 75 MHz			
BC304	TO - 39		V <sub>CEO</sub> : 45 V V <sub>CBO</sub> : 60 V						
			- 45 M	P : 0,3 W	VI	hFE: 75-150		2	5
	PNP	Ampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 45 V V <sub>CBO</sub> : 50 V	T <sub>i</sub> · 125 °C		hpg : 125 - 260		2	5
BC307	TO-92		IC : 0,1 A	.,		f <sub>T</sub> : 150 MHz		10	5
				P : 0,3 W	VI	hpg : 76 - 150		2	5
	PNP	Ampl. BF	VCEO : 25 V VCBO : 30 V	T <sub>i</sub> : 125 °C	Α	hFE 125 - 260		2	9
BC308			IC . 0,1 A			hFE: 240 - 500		2	5
	TO - 92					f <sub>T</sub> : 150 MHz		10	
	PNP	Ampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,3 W	A	hFE : 125 - 260		2	5
BC309		Halibi. D.	VCBO : 25 V	Tj : 125 °C	В	hpg : 240 - 500		2	5
00309	TO - 92		IC : 0,1 A	•		f <sub>T</sub> : 150 MHz		10	5
	PNP	Pilota or zz. e	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 0,8 W		hp£ : 70		10	1
BC313	FINE	vert, TV	VCBO : 70 V	T : 175 °C		fT : 200 MHz		50	10
00310	TO · 5	uscita BF	1c : 1 A	R <sub>thc</sub> : 35 °C/W					
	NPN	Preampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 45 V			hpg : 125 - 500		2	
BC317	NEW	ri campi. Oi	CEO			hpg : 125 - 260		2	
66317	TO - 92A				В	hFE : 240 - 500		2	
			V : 20 V			hfE : 125 - 900	+	2	
	NPN	Preampl, BF	AČEO : 30 A		Α	HFE: 125 - 260		2	
BC318	TQ-92A				В	hFE : 240 - 500	1		
BC318C	NPN TO - 92A	Preampl, BF	VCEO : 20 V			hpg   450 - 900	)	2	
		Preampl, BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V			hp∈: 240 - 900	)	2	
BC319	NPN	rreampi, Oi	- OLO		В	hFE: 250 - 500	)	2	
<b>24010</b>	TO - 92A				С	hFE : 450 - 900		2	
	AUTON)	Ampl. finale	VCEO: 60 V	P : 0,8 W					
BC323	NPN TO - 39	vert. TV	VC80 . 100 V						
			V <sub>CEO</sub> : 55 V	P : 0,8 W		<u> </u>			
BC324	NPN TO - 39	Ampl. finale vert. TV	VCBO : 85 V						
						han 1100 CO		100	
	PNP	Ampl, finale BF	VCES : 50 V	P : 0,5 W		hFE: 100 - 60 f <sub>T</sub> : 100 MHz		10	
BC327		compl. BC337	VCEO : 45 V	Tj : 150 °C R <sub>thc</sub> : 170 °C/W		1 . 100			
	TO - 92		IC : 0,5 A	Tithe . 170 -079					

SIGLA	CONT.	IMPLEGO	VALORI MAS (T <sub>a</sub> = 25 °C)		CARATTERISTICHE (T <sub>a</sub> = 25 °C)	a (mA)	<b>V</b> c (V
BC328	PNP TO-92	Ampl. finale BF compt. BC338	Dati tecnici come VCES : 30 V VCEO : 25 V	BC327 eccetto:			
			*CEG : 25 *				
BC337	NPN TO - 92	Ampt, finale BF compl. BC327	VCES : 50 V VCEO : 45 V	P : 0,5 W Tj : 150 °C	ክϝፎ : 100 - 600 f <sub>T</sub> : 200 MHz	100 10	1 5
_	10.92		IC : 0,5 A	R <sub>the</sub> : 170 °C/W			
BC338	NPN TO 00	Ampl. finate BF compl. BC328	Dati tecnici come VCES : 30 V	BC337 eccetto:			
	TO -92		VCEO : 25 V				
BC370	PNP	Ampl, pilota BF Commutazione	VCEO : 20 V VCBO : 20 V	P : 0,375 W T <sub>1</sub> : 175 °C	hFE: 50 - 500 fT: 150 MHz	to	_ 5
	TO-18		IC : 0,5 A				
8C377	NPN	Ampl. pilota BF Commutazione	VCEO : 45 V VCBO : 50 V	P : 0,375 W T <sub>j</sub> : 175 °C	hFE: 75 - 500 f <sub>T</sub> : 200 MHz	100	1
	TQ - 18		IC : 1 A				
BC378	NPN	Ampl, pilota BF Commutazione	VCEO : 25 V VCBO : 30 V	P : 0,375 W T <sub>i</sub> : 175 °C	hFE: 75 - 500 f <sub>T</sub> : 200 MHz	100	1
	TO-18		IC : 1 A				
BC395	NPN	Ampt. pilota Deflessione	V <sub>CEO</sub> : 70 V V <sub>CBO</sub> : 80 V	P : 0,3 W		•	
	TO - 39	vert. TV	CBO . as s				
BC396	PNP TO - 39	Ampl. finate vert. TV	Dati tecnici come	8C393			•
BC404	PNP	Ampl. alta tensione	VCEO: 80 V	P : 0,36 W	hFE : 160	. 2	
	TO - 92		IC : 0,15 A				
BC405	PNP TO -92	Preampl, BF basso rumore	VCBO : 60 V	P: 0,36 W	hFE : 195		
BC406	PNP TO - 92	Preampt. BF bassissimo rumore	VCBO : 40 V	P : 0,36 W	hFE : 290		
	NPN	Ampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 10 W	hFE: 40 - 250	500	4
BC440	TO - 39	media potenza Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 50 V I <sub>C</sub> : 2 A	T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 200 °C	f <sub>T</sub> :>50 MHz		
BC441	NPN		Implego e dați tec VCEO : 60 V	nici come BC440 eccet	to:		
	TO - 39		VCBO : 75 V				
BC460	PNP		VCEO : 40 V	nici come BC440 eccet	to:		
	TO - 39		VCBO : 50 V				
BC461	PNP		Impiego e dati teo VCEO : 60 V	nici come BC440 eccet	to:		
	TO - 39		VCBO : 75 V				

SIGLA	TIPO 6 CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	SIMI	CARA	TTERISTICHE (a = 25 °C)		V <sub>CE</sub>	f (MHz
BC507	NPN TO - 92	Preampl. BF basso rumore	V <sub>CBO</sub> : 70 V I <sub>C</sub> : 0,2 A	P : 0,36 W		hFE: 230	2		
BC508	NPN TO - 92	Preampt. BF basso rumore	V <sub>CSO</sub> : 60 V I <sub>C</sub> : 0,2 A	P : 0,36 W	·	hFE : 350	2		
BC509	NPN TO - 92	Preampl. BF bassissimo rumore	V <sub>CBO</sub> : 60 V I <sub>C</sub> : 0,2 A	P : 0,36 W		hFE : 195		_	
BC510	NPN TO - 92	Preampl, BF bassissimo rumore	V <sub>CBO</sub> : 40 V I <sub>C</sub> : 0,2 A	P:0,36 W		hFE : 195			
BD 109	NPN SOT-9	Ampl. BF di potenza Commutazione	VCEO : 40 V VCBO : 60 V IC : 3 A	P : 18,5 W Tc : 45 °C Tj : 176 °C Rthc : 7 °C/W	В С D	hFE: 30 - 90 hFE: 50 - 150 hFE: 100 - 300 β: 30 - 300 fT: > 30 MHz	1000 1000 1000 1000 200	2 2 2 2 2	
BD111	NPN TO-3A	Ampl, finale vert, TV	VCEO : 60 V VCBO : 50 V VCEO : 10 A	P : 15 W Tc : 75 °C Tj : 150 °C Rthc : 5 °C/W		hFE: 100 β : 5	500 500	10 5	20
BD115	NPN TO - 39	Ampl. BF e video TV pllota stadi Deflessione TV	VCEO : 180 V VCBO : 245 V IC : 0,15 A	P : 6 W T <sub>a</sub> : 50 °C con diss. alluminio 30 cm², spessore 1,5 m T <sub>j</sub> : 200 °C Rtha : 200 °C/W Rthc : 12,5 °C/W	nm	hFE: 60 f <sub>T</sub> : 145 MHz		100 100	
BD116	NPN TO-3A	Ampl, finale BF	V <sub>CEO</sub> : 60 V V <sub>CBO</sub> : 80 V I <sub>C</sub> : 3 A	P : 20 W T <sub>C</sub> : 50 °C T <sub>j</sub> : 150 °C R <sub>thc</sub> : 5 °C/W		hFE: 120 β: 2,3	200 200	10 10	20
BD117	NPN TO-3A	Ampl. BF di potenza	V <sub>CEO</sub> : 50 V V <sub>CBO</sub> : 100 V	P : 30 W T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 150 °C R <sub>thc</sub> : 3,33 °C/W		hf£ : 70	50	5	
BD1 <b>1</b> B	NPN TO-3A	Regulatore di tensione	V <sub>CEO</sub> : 60 V V <sub>CBO</sub> : 80 V	P : 20 W T <sub>C</sub> : 50 °C T <sub>j</sub> : 150 °C R <sub>thc</sub> : 5 °C/W		hFE: 90 β:>1,5	100 200	5 10	20
BD 124	NPN SOT - 9	Finale BF	V <sub>CEO</sub> : 45 V V <sub>CBO</sub> : 70 V I <sub>C</sub> : 2 A	P : 15 W Tc : 62,5 °C Tj : 175 °C Rthc : 7,5 °C/W		իթը՝ : 60 f <sub>T</sub> : 120 MHz	50 250	5 5	
BD127	NPN SOT - 9	Finale vert. TV	VCEO : 300 V VCBO : 350 V Ic : 0,15 A	P : 16,5 W T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 175 °C		hFE : 70 f <sub>T</sub> : 20 MHz	50 50	20 20	

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (T <sub>8</sub> = 25 °C)	a Ic (mA)	<b>V</b> c (V
BD 128	NPN SOT-9	Implego generale di potenza e alta tensione	Dati tecnici come BD127 eccetto: VCEO : 350 V VCBO : 400 V	hFE : 50	50	20
BD 129	NPN SOT-9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Impiego e dati tecnici come BD128 eccett VCBO : 350 V	o: h <sub>FE</sub> : >10 MHz	50	20
BD135	NPN TO-126	Pilota BF compl. BD136	VCEO: 45 V P: 6,5 W VCBO: 45 V T <sub>C</sub> : 60 °C IC: 0,5 A T <sub>j</sub> : 125 °C Rthc: 10 °C/W	6 hFE: 40 - 100 10 hFE: 63 - 180 16 hFE: 100 - 250 fT: 250 MHz	150 150 150 50	2 2 2 5
BD136	PNP TO - 126	Pilota BF compl. 80135	Dati tecnici come BD135 eccetto:	f <sub>T</sub> : 75 MHz	50	5
BD137	NPN TO-126	Pilota BF compl. BD138	VCEO: 80 V P: 6,5 W VCBO: 80 V T <sub>C</sub> : 60 °C IC: 0,5 A T <sub>j</sub> : 125 °C R <sub>thc</sub> : 10 °C/W	6 hFE: 40 - 100 10 hFE: 63 - 160 fT: 250 MHz	150 150 50	2 2 5
BD138	PNP TO-126	Pilota BF compl. 80137	Data tecnici come BD137 eccetto:	f <sub>T</sub> :75 MHz	50	5
BO139	NPN TD - 126	Pilota BF compl. BD140	Dati tecnici come 8D137 eccetto: VCEO : 80 V VCBO : 80 V			
BD140	PNP TQ - 126	Pilota BF compl. BD139	Dari tecnic: come BD137 eccetto: VCEO : 80 V VCBO : 80 V	† <sub>⊤</sub> : 75 MHz	50	5
BD141	NPN TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	VCED : 120 V P : 117 W VCBO : 140 V T <sub>C</sub> : 25 °C IC : B A T <sub>i</sub> : 200 °C	hFE : 20 -70	2000	4
BD142	NPN TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	VCED : 40 V P : 117 W VCBD : 50 V T <sub>C</sub> : 25 °C IC : 15 A T <sub>j</sub> : 200 °C	hee : 12,5 - 160 f <sub>T</sub> : 1,3 MHz	4000	4
BD144	NPN TO-3	Circuiti defless. vert. TV	V <sub>CER</sub> : 400 V P: 8 W {R <sub>BE</sub> : ≤500 Ω) T <sub>C</sub> : 95 °C V <sub>CBO</sub> : 400 V T <sub>j</sub> : 135 °C IC: 0,25 A R <sub>thc</sub> : 5 °C/W	hFE:>20 f <sub>T</sub> :12 MHz	200 50	20 5
BD145	NPN TO - 3	Circuiti defless, orizz. TV	V <sub>CEO</sub> : 60 V P: 15 W V <sub>CBO</sub> : 60 V T <sub>C</sub> : 100 °C. IC: 5 A T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>the</sub> : 5 °C/W	hFE:>45 f <sub>T</sub> :100 MHz	500 500	10 5
BD 162	NPN SOT-9	Ampl. finale BF Commutazione	VCEO: 20 V P: 23 W VCBO: 40 V Tc: 60 °C IC: 4 A Tj: 200 °C	hfE: 40 - 180 f <sub>T</sub> :>0,8 MHz	500	2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	rMI	CARATTERISTICHE a (T <sub>a</sub> = 25 °C)	Ic (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	f (MHz
BD163	NPN		Impiego e deti tecni VCEO : 40 V	ici come BD162 ecceti	to-			
	SOT-9		ACBO : 60 A					
	NPN	Ampl. 8F	V <sub>CEO</sub> : 60 V	P : 37,5 W	hFE : 20 - 70	4000	4	
BD 191	SOT - 9	di potenza Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 100 V I <sub>C</sub> : 15 A	T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> :>0,8 MHz			
	NPN			ici come BD191 eccet				
BD 192	SOT-9		V <sub>CEO</sub> : 40 V V <sub>CBO</sub> : 50 V		hFE:12,5-160 f <sub>T</sub> : 1,3 MHz	4000	4	
	NPN	Ampl. BF	V <sub>CEO</sub> : 120 V	P : 37,5 W	hFE : 20-70	2000	4	
BD193	SOT-9	di potenza Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 140 V I <sub>C</sub> : 8 A	T <sub>c</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 175 °C				
	NPN	Ampl. BF	VCEO : 300 V	P : 21,5 W	hFE:>40	100	10	
BD215	SOT-9	di potenza Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 500 V I <sub>C</sub> : 0,5 A	T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>Υ</sub> : 10 MHz ·			
	NPN	Ampi, BF	VCEO : 200 V	P : 21,5 W	hee : 40 - 150	100	10	·
BD216	SOT - 9	di potenza Commutazione	V <sub>CBO</sub> : 300 V I <sub>C</sub> : 1 A	T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> : 10 MHz			
	NPN	Ampl. finale	VCEO : 110 V	P : 0,6 W	hFE:>20	10	10	
BF109	TO-5	video TV Commutazione	VCBO: 135 V IC: 50 mA	T <sub>C</sub> : 100 °C T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>\$\frac{1}{4}</sub> : 135 MHz	10	10	
	NPN	Ampl. finale	V <sub>CES</sub> : 160 V	P : 2,5 W	hpE:>30	10 10	10 10	
BF110		video TV	IC : 40 mA	T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 200 °C	† <sub>T</sub> : 150 MHz			
	TO-39			R <sub>tha</sub> : 250 °C/W				
	NPN	Ampl. video per TV color	V <sub>CER</sub> : 200 V {R <sub>BE</sub> : ≤ 1 kΩ}	P : 3 W T <sub>c</sub> : 100 °C	hFE:>20 f <sub>T</sub> :120 MHz	60 20		
BF111	TO-39		IC ; 80 mA	T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>tha</sub> : 200 °C/W				
	NPN	Ampl, finale	VCEO : 130 V	P : 0,59 W	hpg : >30	10	10	
BF114		video TV	VCBO : 160 V IC : 50 mA	T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> :>80 MHz	10	10	
	TO-5			R <sub>thc</sub> : 60 °C/W				
	NPN	Ampl. RF AM-FM	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P:0,145 W Ta: 45 °C	hpe: 47 - 165 vie : 30 mS	1	10 10	100
BF115		Ampl. 8F basso rumore	VCBO : 50 V IC : 30 mA	T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> ; 230 MHz	1	10	
	TO - 72R				f <sub>β</sub> : 1 MHz			
8F117	NPN TO - 5 TO - 39	Ampt. finale video TV	V <sub>CEO</sub> : 140 V	P:1,2W	hFE:>25 f <sub>T</sub> :100 MHz	30		
	NPN	Oscill. conv. TV-FM		P : 0,2 W	hFE: 50	3		,
BF 152	TO - 106		VC80 : 30 V	T <sub>j</sub> : 125 °C R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	β : 8 f <sub>T</sub> :600 MHz	3	10	1

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (T <sub>a</sub> = 25 °C)	SIMI	CARATTERISTICHE a (T <sub>a</sub> = 25 °C)		Vce (V)	f (MHz
	NPN	Ampi, FI-AM	V <sub>CED</sub> : 12 V	P : 0,2 W	hFE: 50	3	6	
3F163			VCBO: 30 V	Tj : 125 °C	β : 4	3	6	100
11 103				R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	G <sub>tr</sub> : 44 dB	3	6	0,47
	TO - 106				f <sub>T</sub> : 400 MHz			
	NPN	Ampl. pilota	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,3 W	hpE : 50	10	10	
3F154		video TV	VCBO : 30 V	Tj : 125 °C	β : 4	2	10	100
	TO - 105			R <sub>thc</sub> : 125 °C/W	f <sub>T</sub> : 400 MHz			
	NPN	Oscill. conv. UHF	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 175 mW	hFE: 70	2.5	12	
3F 155			V <sub>CBO</sub> : 40 V	Tj : 175 °C	β : 6	2,5	12	100
	TO - 72		lc : 20 mA	R <sub>thc</sub> : 580 °C/W	1 <sub>T</sub> : 400 MHz			
BF 156	NPN	Ampl. finala	V <sub>CEO</sub> ; 120 V	P:0,8W				
	TO - 5	video TV	V <sub>CBO</sub> : 120 V		_			
	NPN	Ampl. finale	VCEO : 150 V	P : 0,8 W	<del></del>	•		
BF 157	TO - 5	video TV	V <sub>CBO</sub> : 150 V	(-				
	NPN	Ampl. FI - TV	V <sub>CEO</sub> : 12 V	P : 0,2 W	hFE: 50	4	10	
			VCBO : 30 V	T <sub>i</sub> : 125 °C	β : 8	5	10	100
3F 158				Rthc : 200 °C/W	Gtr : 26 dB	5	10	40
	TO-106				f <sub>T</sub> ; 600 MHz			
	NPN	Ampl. FI - TV	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,2 W	hFE: 50	4	10	
			VCBO : 40 V	T; : 125 °C	β : 8	5	10	100
3F159				R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	G <sub>1r</sub> : 26 dB	5	10	40
	TO - 106				f <sub>T</sub> : 600 MHz			
	NPN	Ampl. Fl	V <sub>CEO</sub> : 12 V	P : 0,2 W	hFE: 50	3	10	
BF 160		per AM - FM	VCBO: 30 V	Tj : 125 ℃	β:6	3	10	100
SF 160				R <sub>thc</sub> : 200 °C/W	G <sub>tr</sub> : 32 dB	3	8	10,7
	TO-106				f <sub>T</sub> : 400 MHz			
-	NPN	Oscill, conv UHF	V <sub>CEO</sub> : 50 V	P : 175 mW	hFE : 60	3	10	
- <b>-</b>			V <sub>CBO</sub> : 50 V	Tj : 175 °C	β : 5,5	3	10	100
3F161			IC : 20 mA	R <sub>thc</sub> : 580 °C/W	G <sub>UM</sub> : 12 dB	1,5	24	800
	TO - 72				f <sub>T</sub> : 350 MHz			
	NPN	Ampl. RF-FI e	VCEO: 40 V	P : 0,2 W	hFE : 70	4		
BF162		oscill.	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C	f <sub>T</sub> : 400 MHz			
	TO - 106			R <sub>thc</sub> : 200 °C/W				
	NPN	Ampl, FI per TV	VCEO : 40 V	P : 0,2 W	hFE : 70	4	10	
		AGC	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C	β : 6	4	10	100
BF 163				Rthc: 200 °C/W	G <sub>UM</sub> : 30 dB	4	10	40
	TO-106				f <sub>T</sub> : 400 MHz			
	NPN	Impiego	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 175 mW	hFE : 50	2,5	12	
BF 166		generale RF	VCBO : 40 V	Tj : 175 °C	β : 5	2,5	12	100
BF 100	TO-72			R <sub>thc</sub> : 580 °C/W	G <sub>UM</sub> ): 18 dB f <sub>T</sub> :300 MHz	3	10	200
	10-72							
		Ampl. RF - FI	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,13 W	hpg : 57	4	10	35
	NPN							
BF 167	NPN	per TV stadio controllato	V <sub>CBO</sub> : 40 V I <sub>C</sub> ; 25 mA	T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>j</sub> : 175 °C	yfe : 105 mS G∪M : 42 dB	4	10 10	35

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T <sub>a</sub> = 25 °C)	ымі	CARATTERISTICHE a (Ta = 25 °C)			f (MHz
	NPN	Preampt video TV	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,3 W	β : 200 - 500	2	5	
BF169		,	VCBO : 50 V	T; : 175 °C	f <sub>T</sub> : 250 MHz	2	5 .	
	TO - 18		IC : 50 mA	R <sub>thc</sub> : 200 °C/W				
BF169R	NPN RQ - 110		Împiego e dati tecr	nici come BF169 eccer T <sub>i</sub> · 125 °C	10:			
	NPN	Preampt, video TV	V <sub>CEQ</sub> : 30 V	P : 175 mW	heE: 90-330	1	10	_
BF169A			VCBO: 30 V	Tj : 175 °C	1 <sub>T</sub> : 250 MHz	1	10	
	TO - 72R		IC : 30 mA	R <sub>the</sub> : 500 °C/W				
	NPN	Preampl, video TV	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,3 W	hFE:>90	1	10	
BF169RA			V <sub>CBO</sub> : 30 V	T <sub>i</sub> · 125 °C	f <sub>T</sub> : 250 MHz	1	10	
	RO - 1108		IC : 30 mA					
	NPN	Ampl, uscita FI	V <sub>CEO</sub> . 25 V	P . 0,26 W	hFE : 88	7	10	
		video TV	VCBO : 40 V	Ta : 45 °C	Yfe : 145 mS	7	10	35
BF173			Ic : 25 mA	aletta n. 2	G <sub>UM</sub> . 42,5 dB	7	10	35
				Tj : 175 °C	f <sub>T</sub> : 550 MHz	5	10	
	TO - 72R			R <sub>tha</sub> : 0,65 °C	·			
	NPN	Ampl. finale video	V <sub>CEO</sub> : 150 V	P : 0,8 W	hFE : 70	10	50	
BF174			VCBQ : 150 V	T <sub>j</sub> 7 200 °C	β : 4	10	50	20
	TO - 39		IC : 0,1 A	R <sub>thc</sub> : 58 PC/W				
	NPN	Ampl, FI per TV	VCEO : 40 V	P : 175 mW	hFE : 70	2,5	12	
BF 175		AGC	VCBO: 40 V	T <sub>f</sub> : 175 °C	β : 5	2,5	12	100
	TO - 72			R <sub>thc</sub> : 583 °C/W	G <sub>UM</sub> : 30 dB	4	12	40
	NPN	Ampl. FI per TV	VCEO : 40 V	P : 0,25 W	hFE : 65	10	10	
BF176			VCBO : 40 V	Tj : 125 °C	β : 4,5	10	10	100
	TO - 105			Rthc: 200 °C/W	G <sub>UM</sub> : 30 dB	10	fO	36
	NPN	Ampl. finale	VCEO: 60 V	P : 0,6 W	hFE:>20	15	10	
		video TV	VCBO : 100 V	Ta : 65 °C	f <sub>T</sub> : 120 MHz	10	10	
BF177	TO-5		IC : 50 mA	Tj : 200 °C				
	TO - 39			R <sub>thc</sub> : 45 °C/W				
	NPN	· -	Impiego e dati tec	nici come BF177 eccet	to:			
BF178	TO - 5		VCEO : 110 V					
	TO - 39		V <sub>CBO</sub> : 160 V		<u> </u>			
-	NPN		Impiego e dati teci	nici come BF177 eccet	to:			
0.54355				P : 0,5 W				
BF178T	TO-5			T <sub>a</sub> : 65 °C				
	TO - 39	١		R <sub>thc</sub> : 75 °C/W				
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BF177 eccet	to:			
BF179	TO-5		VCEO : 115 V					
	TO - 39		V <sub>CBO</sub> : 250 V					
	NPN	Ampl. finale	VCEO : 115 V	P 1,7 W	hFE:>20	20	15	
DC170A		video TV colore	V <sub>CBO</sub> : 160 V	T <sub>C</sub> 125 °C	f <sub>T</sub> : 120 MHz	10	10	
BF179A	TO-5		IC : 50 mA	τ <sub>j</sub> : 200 °C				
	TO - 39			R <sub>tha</sub> : 220 °C/W				

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T <sub>8</sub> = 25 °C)	CARATTERISTICHE a {T <sub>d</sub> = 25 °C}			f (MHz
BF179B	NPN TO-5		Impiego e dati tecnici come BF179 eccetto: VCBO : 220 V				
DF (730	TO -39		*C80 . 224 *				
_	NPN		Impiego e dati tecnici come BF179 eccetto	:			
BF179C	TO - 5 TO - 39		VCBO : 250 V P : 0,6 W				
	NPN	Ampl. RF	VCEO : 20 V P : 150 mW	hFE : 45	2	10	
BF180	TO - 72	UHF - VHF	VCBO: 30 V T <sub>j</sub> : 175 °C IC: 20 mA	G <sub>UM</sub> . 12 dB f <sub>T</sub> : 675 MHz	2	10 10	900
	NPN	Oscill, conv. UHF	Dati tecnici come BF180 eccetto:	hFE : 29	2	10	
BF181	TO-72			G⊔M : 11 dB fT :600 MHz	2	10 10	900
-	NPN	Oscill, conv.	V <sub>CEO</sub> : 20 V P : 150 mW	hFE : 20 dB	2	10	
		VHF - UHF	VCBQ : 25 V T <sub>i</sub> : 175 °C	Yfb : 18 mS	2	10	900
BF 182			Ic : 15 mA	G <sub>UM</sub> : 11 dB	2	10	900
	TO -72		<u> </u>	f <sub>T</sub> : 650 MHz	2	10	
	NPN		Impiego e dati tecnici come BF182 eccetto	: hFE : 25 G <sub>UM</sub> 13 dB	3	10 10	900
BF1B3	TO - 72			f <sub>T</sub> : 800 MHz	3	10	
	NPN '	Ampl. RF-FI	VCEO : 20 V P : 145 mW	hFE: 75-750	1		
BF 184		per AM - FM	V <sub>CBO</sub> : 30 V T <sub>a</sub> : 45 °C	y <sub>fe</sub> : 35 mS	1	10	100
	TO - 72R		IC : 30 mA T <sub>i</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> : 300 MHz	1	10 —	
	NPN		Impiego e dati tecnici come BF184 eccetto	hpe: 34 - 140 yfe: 33 mS	1	10 10	100
BF 185	TO-72R			f <sub>T</sub> : 220 MHz	i	10	
	NPN	Ampl, finale	VCER : 190 V P : 2,75 W	hFE : >20	40	20	
BF186		di luminanza	$(R_{BE}:\leqslant 1 \text{ k}\Omega)$ T <sub>c</sub> : 145 °C	f <sub>T</sub> : 120 MHz	10	10	
DF 140	TO - 39		V <sub>CBO</sub> : 190 V				
	NP N	DC 61	V <sub>CEO</sub> : 20 V P : 0,22 W	heE : 115	1	10	
BF 194	MM-12R	Ampl. RF - F1 oscill. per AM · FM	V <sub>CBO</sub> : 30 V T <sub>j</sub> : 125 °C	Vfe : 35 mS	1	10	35
5, 154	SOT · 25R	Value Per 1 m	IC : 30 mA	f <sub>T</sub> : 260 MHz	1	10	
	NPN		Impiego e dati tecnici come BF194 eccetto	o: hFE: 67	1	10 10	100
BF 195	MM-12R			γ <sub>fe</sub> 31 mS f= 200 MHz	1	10	100
	SOT-25R	•		f <sub>T</sub> ± 200 MHz			
	NPN	Ampl. FI - TV CAG	V <sub>CEO</sub> : 30 V P : 0,25 W V <sub>CBO</sub> : 40 V T <sub>j</sub> : 125 °C	hFE : >20 Yfe : 100 m\$	6 4	10 10	45
BF196	MM-12R		IC : 25 mA	G <sub>UM</sub> : 39 d8	4	10	45
	SOT - 25R			f <sub>T</sub> : 400 MHz	- 4	10	
	NPN	Ampl, uscita FI	VCEO : 25 V P : 0,25 W	hFE :>38	7	10	
BE103		video TV	VCBO: 40 V T <sub>3</sub> : 125 °C	Vfe : 155 mS	7	10 10	45 45
BF197	_ MM-12R		IC : 25 mA	G <sub>UM</sub> : 41 dB fT :550 MHz	6	10	
	SOT - 25H			·T . 550 WILL	·		

SIGLA	TIPO e CONT.	MPIEGO	VALOR! MAS. (T <sub>3</sub> = 25 °C)		CARATTERISTICHE (T <sub>a</sub> = 25 °C)	a Ic (mA)	V <sub>CE</sub>	f (MHz)
	NPN							
BF198	TQ-92R MM-11R		Impiego e dati tec	nici come BF196				
	NPN							
BF 199	TO - 92R MM - 11R		Impiego e dati tec	nici come BF197				
	NPN	Ampl, VHF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P 0,15 W	hFE : 30	3 2	10 10	100
BF200			V <sub>CBO</sub> : 30 V ∤ <sub>C</sub> : 20 mA	T <sub>j</sub> . 175 °C	γ <sub>fe</sub> · 56 m9 G <sub>UM</sub> · 22 d8		10	200
	TO -72				†T : 650 M	lz 3	10	
	NPN	Oscill conv. UHF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,2 W	hFE : 70	2	10	
BF206	TO -72		V <sub>CBO</sub> : 30 V I <sub>C</sub> : 20 mA	T <sub>1</sub> : 175 °C R <sub>thc</sub> : 400 °C/W	Gp : 20 dB f <sub>T</sub> :500 MF		10 10	200
				11(1)2 1 100 0/11				
	NPN	Ampl FI	VCEO : 30 V	P . 0,15 W	η <b>Ε</b> Ε 80	4	10	20.0
BF207		video TV stadio controllato	V <sub>CBO</sub> : 40 V Ic : 25 mA	T <sub>i</sub> : 175 °C	у <sub>fe</sub> : 95 mS G <sub>UM</sub> : 42 dB		10 10	36,6 36,6
	TQ - 72R		i( . 20 iiin		t <sub>T</sub> . 400 MF		10	30,0
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BF207 eccet	lo.			
BF207R	RO - 110R			P : 0,3 W				
	NPN	Ampl. FI	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,23 W	hFE : 100	7	10	
BF208		video TV	V <sub>CBO</sub> : 40 V	Tj · 175 °C	y <sub>fe</sub> 145 mS	7	10	36,6
	TO - 72R		1c : 25 mA		G <sub>UM</sub> : 43 dB f <sub>T</sub> . 600 MF		10 10	36,6
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BF206 eccet	to			
BF208R	RO - I 10R			P : 0,3 W				
	NPN	Ampt. RF per UHF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,2 W	ήFΕ: 80		10	
BF212			V <sub>CBO</sub> : 30 V	Tj : 175 °C	f <sub>T</sub> : 600 MHz	:		
	TO - 72		lc : 20 mA					
BF213	NPN	Conv UHF	Dati tecnici come	BF212 eccetto:	hFE: 50		10	
BF213	TO - 72				f <sub>T</sub> : 550 MHz	1	10	
	NPN	Oscill, conv.	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 165 mW	hFE: 90-330		10	
BF214		per OM - OC	VCBO : 30 V	Tj : 175 °C	γ <sub>fe</sub> : 35 mS	1	10 10	10,7
	TO-72R	Ampl. FI per AM - FM	fc : 30 mA	R <sub>thc</sub> : 500 °C/W	f <sub>T</sub> : 250 MHz		10	
	NPN	Preampl. RF	Dati tecnici come	BE214 eccetto:	hFE : 40-165	1	10	
BF215		oscill, conv. per FM			у <sub>fb</sub> : 33 mS	1	10	100
	NPN	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 50 V	P : 175 mW	hFE : 60	2	7	
BF222		conv. FM	VCBO : 50 V	Tj : 175 °C	β : 4	2	7	100
	TO - 72		1 <sub>C</sub> : 20 mA	R <sub>thc</sub> : 577 °C/W	G <sub>UM</sub> : 20 d8	4	5	100
	NPN	Ampl. FI	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,35 W	hFE: >40	15	10	26
BF223		per TV colore	V <sub>CBO</sub> : 35 V	Tj : 140 °C	y <sub>fe</sub> ; 200 mS ← ; 750 MH:	. 7 . 5	10 10	36
	MM-12R		IC : 40 mA	Rthc: 230 °C/W	f <sub>T</sub> : 750 MHz			

SIGLA	TIPO F CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS			ATTERISTICHE a T <sub>a</sub> = 25 °C)	I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CE</sub>	f (MHz
	NPN	Ampl. FI	VCEO : 25 V	P : 50 mW		hfE : 100	3	10	
BF227		video TV	VCBO : 40 V	Ta: 45 °C		y <sub>fe</sub> : 80 mS	3	10	36
	TOM-23R		IC : 25 mA	T <sub>j</sub> : 125 °C		t <sub>T</sub> : 600 MHz	3	10	
	NPN	Ampl pilota	V <sub>CEO</sub> : 80 V	P : 50 mW		hFE: >30	2	10	
BF228	TOM - 23	per nixie	VCBO: 7 V IC: 50 mA	T <sub>a</sub> : 45 °C T <sub>i</sub> : 125 °C		f <sub>T</sub> :>50	10	10	
	NPN		Implego e dati teo	nici come 8F194 ecce	tto:				
BF229				P 50 mW					
	TOM · 23R			Ta: 45 °C					
	NPN		Impiego e dati tec	nici come BF195 ecce	tto:				
BF230	TOM 000			P : 50 mW					
	TOM - 23R			Ta : 45 °C					
	NPN	Ampl. FI	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,23 W		hFE: >30	7	10	
BF232	FO 300	video TV	V <sub>CBO</sub> : 48 V	Tj : 175 °C		f <sub>T</sub> : 600 MHz	10	10	
	TO-72R		IC : 30 mA	R <sub>thc</sub> : 350 °C/W					
	NPN	Oscill, conv.	VCEQ : 30 V	P:0,3 W	2	hFE: 40 - 70	1	10	
٠.		per OM - OC	ACBO : 30 A	Tj : 125 °C		hFE: 60 - 100	1	10	
		Ampl. Fl	IC : 30 mA		4		1	10	
BF233		per AM - FM			5 6	hpg : 140 - 220	1	10 10	
						hpE: 200 - 350 Vfe: 33 mS	i	10	10.7
	RO - 110R					f <sub>T</sub> : 250 MHz	3	10	
BF234	NPN RQ - 110R		Impiega e dati teo	onici come BF233 ecce	tto:	hFE : 90 - 330	1	10	
BF 235	NPN RO-110R	Preampl, RF oscill. conv. FM	Dati tecnici come	BF233 eccetto:		hFE: 40 - 165	1	10	
	NPN	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 225 mW		hFE: 67-220			
BF240	TO-92R	per AM - FM	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C		yfe : 75 mS	2	10	10,7
	MM-11R		1 <sub>C</sub> : 25 mA	·		1 <sub>†</sub> : 430 MHz	1	10	
	NPN	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 40 V	P : 225 mW		hpE: 36-125			
BF241	TO-92R	per AM e	VCBO : 40 V	Tj : 125 °C		Yfe : 75 mS	2	10	10,7
	MM-11R	FM - AGC	lc : 25 mA			f <sub>T</sub> : 400 MHz	1	10	
	NPN								
BF254	TO - 92R		Impiego e dati ter	cnici come BF194					
	MM-11R								
	NPN								
BF255	TO-92R MM-11R		Impiego e dat⊩tei	onici come BF195					
	NPN	Ampl, finale	VCEO : 160 V	P : 5 W		hFE:>25	30	10	
BF257		video TV	IC : 0,1 A	T <sub>C</sub> : 25 ℃		f <sub>T</sub> : 110 MHz	30		
	TO-39			Tj: 125 °C					

SIG <b>L</b> A	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS (Ta = 25 °C)		CARATTERISTICHE {T <sub>B</sub> = 25 °C)		V <sub>CE</sub> (V)	f {MHz
BF258	NPN TO - 39	Ampl. finale video TV	V <sub>CEO</sub> : 250 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	P : 5 W T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 125 °C	hFE : >25 f <sub>T</sub> : 110 MHz	30 30	10	
BF259	NPN TO - 39	Ampl, finale video TV	VCEO : 0,1 A	P : 5 W T <sub>C</sub> : 25 °C T <sub>j</sub> : 125 °C	hf€ : >25 1 <sub>T</sub> : 110 MHz	30 30	10	
BF280	NPN TO - 72R	Preampl. VHF CAG	VCBO : 45 V IC : 50 mA	P : 0,15 W T <sub>j</sub> : 175 °C	hFE: 70 1 <sub>T</sub> : 800 MHz	1	6	
BF261	NPN TO-72R	Ampl. FI CAG	Dati techici come VCBO - 40 V	BF260 eccetto:	f <sub>T</sub> : 730 MHz			
BF270	NPN TO-72R	Ampl. Fl per TV stadio controllato	VCEO : 40 V VCBO : 40 V IC : 20 mA	P : 0,150 W T <sub>I</sub> : 175 °C R <sub>thc</sub> : 750 °C/W	hfE:45 β : 6	3,5 3,5	10 10	100
BF271	NPN TQ-72R	Ampl. FI-TV	VCFO : 40 V VCBO : 40 V IC : 30 mA	P : 0,24 W T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>thc</sub> : 375 °C/W	hfe:75 β :10	10 10	15 15	100
BF287	NPN TO-72A	Oscill, conv. per AMI Ampl. FI per AM - FM	VCEO : 40 V VCBO : 40 V IC : 20 mA	P : 0,150 W T <sub>j</sub> : 175 °C B <sub>thc</sub> : 750 °C/W	hfE:50 β · 6	1	7	100
BF288	NPN TO-72R	Àmpl. FI per AM-FM stadio controllato	Dati tecnici come	8F287 eccetto:	hFE:90 β . 5	1	7	100
BF290	NPN TO - 72R	Oscill, conv. UHF	Dati tecnici come	BF287 eccetto:	hFE:60 β : 9	3	10 10	100
8F291	NPN TÖ - 18	Pilota video Eleboratora di segnali di colore	VCEO : 40 V VCBO : 50 V 4C : 0,1 A	P : 0,36 W T <sub>j</sub> : 200 °C R <sub>thc</sub> : 146 °C/W	A heg : 105 B heg : 170 β : 3,8 t <sub>on</sub> : 28 toff : 237 os	2 2 10 50	10 10 10 30 30	100
BF292A	NPN TO - 5 TO - 39	Uscita video alta tensione	V <sub>CEO</sub> : 150-V V <sub>CBO</sub> : 150 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	P : 0,8 W T <sub>I</sub> : 200 °C R <sub>thc</sub> : 35 °C/W	hFE: 70 β : 3,3	10 10	50 50	20
BF 292B	. NPN TO-5 TO-39		Impiego e dati ted VCEO : 190 V VCBO : 190 V	nici come RF292A ecce	tto:			
BF292C	NPN TO-5 TO-39		Impiego e dati teo VCEO : 220 V VCBO : 220 V	mici come BF292A ecce	nto:			
BF302	NPN TO-72R	Ampl. FI per AM - FM	VCBO : 40 V IC : 50 mA	P : 0,15 W T <sub>j</sub> : 175 °C	hpg : 35 - 125 † : 650	1	6	

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T <sub>a</sub> = 25 °C)		CARATTERISTICHE a (Ta = 25 °C)			f (MHz
BF303	NPN · TO - 72R	Ampl. FI per AM	V <sub>CBO</sub> : 40 V IC : 60 mA	P : 0,15 W T <sub>j</sub> : 175 °C	hfE: 110 - 220 f <sub>T</sub> : 500 MHz	ı	6	
BF304	NPN TO - 72R	Ampl. RF per VHF	V <sub>CBO</sub> : 40 V I <sub>C</sub> : 50 mA	P : 0,15 W T <sub>j</sub> : 175 °C	hFE: 35 - 120 f <sub>T</sub> : 500 MHz	1	6	
BF305	NPN TO - 39	Ampl. finale video TV	V <sub>CBO</sub> : 185 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	P : 0,6 W T <sub>a</sub> : 65 °C T <sub>i</sub> : 200 °C	hFE: 20 f <sub>T</sub> : 100 MHz			-
BF306	NPN TO - 72R	Ampř. FI video TV	V <sub>CEO</sub> : 25 V V <sub>CBO</sub> : 40 V I <sub>C</sub> : 25 mA	P : 0,175 mW T <sub>j</sub> : 175 °C	hFE: 37 f <sub>T</sub> :1000 MHz	7	10	
BF310	NPN FO -92	Ampl. FI - TV	VCEO : 30 V IC : 25 mA	P:0,24 W Ta: 45 °C	$^{ m hFE}:>28$ $^{ m yfe}:>80~{ m mS}$ $^{ m f}_{ m T}:<580~{ m MHz}$	4 4 1		
BF311	NPN TO -92R	Ampl. FI - TV	VCEO : 25 V IC : 40 mA	P : 0,28 W Ta : 45 °C	hpe : >40 yfe : >155 mS fT : 750 MHz	15 7 5		
BF314	NPN TO - 92	Ampl. conv. per VHF	VCEO : 30 V ¢C : 25 mA	P : 0,24 W T <sub>a</sub> : 45 °C	hFE:>28 Y <sub>1e</sub> :36 mS F <sub>T</sub> :<580 MHz	4 1 1	10 10 10	
BF329	NPN SOT - 25R		Impiego e dati teo	nicl come BF196				
BF330	NPN SOT - 25R		Impiego e dati teo	nici come BF197				
BF332	NPN SOT - 25R	Conv. oscill, AM	V <sub>CBO</sub> : 30 V Ic : 30 mA	P:0,25 W Tj:125 °C	hFE: 65 - 220 fT: 600 MHz	1	10	
BF333	NPN SOT - 25R	Ampl. FI	Dati tecnici come	BF332 eccetto:	bFE: 35 - 120 f <sub>T</sub> : 400 MHz	ŧ	10	
BF334	NPN SOT-25R	Ampl. Fil per AM - FM	V <sub>CEO</sub> : 30 V V <sub>CBO</sub> : 40 V 1 <sub>C</sub> : 25 mA	P : 0,25 W T <sub>j</sub> : 125 °C	hFE: 65-220 Yfe: 36 mS fT: 430 MHz	1 F 1	10 10 10	10,7
BF335	NPN SOT - 25 R		Impiego e dati tec	nici come BF334 eccett	o: hFE: 35 - 125 f <sub>T</sub> : 370 MHz	1	10 10	
BF336	NPN TO - 39	Ampl, finale video TV	VCEO : 180 V VCBO : 185 V IC : 0,1 A	P : 3 W T <sub>C</sub> : 140 °C T <sub>j</sub> : 200 °C R <sub>tha</sub> : 220 °C/W	hFE:>20 f <sub>T</sub> :>80 MHz	30 30	10 20	
BF337	NPN TO - 39		Impiega e dati teo VCEO : 200 V VCBO : 250 V	mici come BF336 eccett	ю:			

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (Ta = 25 °C)	:	CARATTERISTICHE a	1c (mA)	(V)
05320	NPN			no come BF336 eccetto	ı:		
BF338	TO - 39		V <sub>CBO</sub> : 225 V V <sub>CBO</sub> : 300 V				
	NPN	Ampl, RF - FI	V <sub>CEO</sub> : 30 V	P : 0,15 W	hFE: 90 - 220	1	10
0 F344	TO - 18R		IC : 50 mA	T <sub>J</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> : 500 MHz		
BF345	NPN TO - 18R		Impiego e dati tecr	nici come BF344 eccetto	i: hpg: 40 - 115	1	10
BF390	NPN	Ampl. uscita	V <sub>CBO</sub> : 310 V	P : 0.6 W Ta : 65 °C	ክϝΕ : 20 # <sub>T</sub> : 120 MHz	,	
BF390	TO - 39	I V Colore	IC : 0,1 A	T <sub>1</sub> : 175 °C	7 . 120 MH2		
	NPN	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,3 W	hFE : >35	10	10
BFY37	TO - 18	Oscill, VHF	V <sub>CBO</sub> : 25 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	T <sub>j</sub> : 175 °C R <sub>the</sub> : 150 °C/W	1 <sub>T</sub> :>200 MHz	10	10
	NPN	Ampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P : 0,3 W	1 heg : 35 - 110	10	10
		Oscill, VHF	VCBO : 45 V	Tj : 175 °C	2 hFE: 100 - 200	10	10
BFY39			IC : 0,1 A	R <sub>thc</sub> . 150 °C/W	3 h <sub>FE</sub> : 180 - 400 β : 180 - 400	10 1	10 10
	TO - 18				1 <sub>T</sub> : 150 MHz	10	10
BFY41	NPN	Ampt. finale video TV	V <sub>CER</sub> 120 V (R <sub>BE</sub> < 250 Ω) V <sub>CBO</sub> · 120 V	P : 0,8 W T <sub>j</sub> : 200 °C R <sub>thc</sub> : 58 °C/W	hFE :>35	50	10
	TO - 39		(C : 0.6 A	THE TOTAL PARTY			
	NPN	Ampl. finale	V <sub>CEO</sub> : 140 V	P : 0,8 W	hFE: >25	10	10
BFY43	TO - 39	video TV	V <sub>CBO</sub> : 140 V I <sub>C</sub> : 0,1 A	Tj : 175 °C	f <sub>T</sub> : 60 MHz	10	10
	NPN	Impiego generale	V <sub>CEO</sub> : 35 V	P : 0,8 W	hFE : 55	150	8
BFY50	TO - 5	Commutazione	ACBO : 80 A	Tj : 200 °C	β : 45	10	6 6
	TO - 39		Ic : 1 A	R <sub>thc</sub> : 35 °C/W	f <sub>T</sub> : 100 MHz	50	
	NPN	Impiego generale	VCEO : 30 V	P : 0,8 W	hFE: 70	150	6
BFY51	10-5	Commutazione	VCBO : 60 V	т <sub>і</sub> . 200 °С	β : 60	10	6
	TO - 39		1C : 1 A	R <sub>thc</sub> : 35 °C/W	f <sub>T</sub> : 110 MHz	50	- 6
	NPN	Impiego generale	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,8 W	hFE: 130	150	6
BFY52	TO - 5	Commutazione	VCBO : 40 V	Tj : 200 °C	β : 120	10	6
	TO - 39		IC : 1 A	R <sub>thc</sub> : 35 °C/W	f <sub>T</sub> : 120 MHz	50	
	NPN	Ampi. RF	VCEO : 32 V	P : 0,3 W	hFE: >35	50	5
BSX24		Oscill VHF	VCBO : 32 V	Tj : 175 °C	f <sub>T</sub> : 200 MHz	10	10 10
201124	TÓ - 18	Commutazione	IC : 0,1 A	R <sub>thc</sub> : 150 °C/W	t <sub>an</sub> : 25 ns t <sub>off</sub> : 400 ns	10 10	10
·	NPN	Oscill, conv	VCEO : 25 V	P : 0.8 W	h <sub>FE</sub> : 50	1	10
BSY51	FWEIN	per OM - OC	VCBO : 60 V	Ti 200 °C	β : 30 - 100	1	5
	TO - 39	Commutazione	IC : 0,5 A	R <sub>thc</sub> : 58 °C/W	fT : 100 MHz	50	10

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a IC (mA)	V <sub>CE</sub> (V)
	NPN		Impiego e dati tecnici come BSY51 eccetto:	: hfE : 100	1	10
BSY52	TO - 39		,	β : 50 - 200 1 <sub>T</sub> : 130 MHz	· 50	5 10
BU100	NPN	Ampl. finale	VCEO : 60 V P : 15 W VCBO : 150 V T <sub>C</sub> : 75 °C	hRE: 100	500	10
B0 100	TO-3A	OHZZ. 1 V	VCBO : 150 V T <sub>C</sub> : 75 °C IC : 10 A T <sub>j</sub> : 150 °C			
	NPN	Ampi. finale	VCEO : 150 V P : 25 W	hFE: 110	1000	6
BU102	TO-3A	orizzTV	V <sub>CBO</sub> : 400 V	$t_{on}$ : 0,66 $\mu$ s $t_{off}$ : 1,1 $\mu$ s		
	NPN	Finale vert. TV	VCER: 120 V P: 30 W	hpg: 50-200	200	10
BU103	TO - 66		(R <sub>BE</sub> : 220 Ω) T <sub>C</sub> : 25 °C V <sub>CBO</sub> : 120 V T <sub>j</sub> : 175 °C	f <sub>T</sub> : 100 MHz	100	10
BU104	NPN	Finale orizz, TV	V <sub>CEX</sub> : 400 V P: 85 W V <sub>CBO</sub> : 400 V T <sub>C</sub> : 25 °C	hFE: 10-50 fT: 10 MHz*	5000	3,5 10
50104	TO-3		IC : 7 A Tj : 200 °C			
DUISOF	NPN	Defless. orizz. TV	V <sub>CER</sub> :750 V P : 10 W (RgE:≤100 Ω) T <sub>C</sub> : 90 °C	hre: B f <sub>T</sub> : 7,5 MHz	800 100	5 5
BU105	TO-3		V <sub>CBO</sub> : 750 V T <sub>j</sub> : 115 °C I <sub>C</sub> : 2,5 A			
BU108	NPN	Defless, orizz. TV colore	$V_{CER}$ : 750 V P: 12.5 W $(R_{BE}$ : ≤ 100 Ω) $T_{C}$ : 95 °C $V_{CRO}$ : 750 V $T_{j}$ : 115 °C	hre:4 f <sub>T</sub> :7 MHz	4000 100	5 5
	TO-3		tc : 5 A			
BU109	NPN		Impiego e dati tecnici come BU104 eccetto VCEX : 330 V	:		
	TO-3	<u> </u>	V <sub>CBO</sub> : 330 V V <sub>CEX</sub> : 550 V P : 85 W	hFE:>7	6000	
BU112	NPN TO-3	Finale orizz. TV colore	VCEX: 550 V P: 85 W VCBO: 550 V T <sub>c</sub> : 25 °C IC: 10 A T <sub>j</sub> : 200 °C	"FE . 27		
BU113	NPN TO-3		Impiego e dati tecnici come BU112 eccetto VCEX : 700 V			•
BU115	NPN	Defless, orizž, TV cotore	V <sub>CER</sub> : 600 V P: 50 W {R <sub>BE</sub> : ≤10 Ω} T <sub>C</sub> : 75 °C	hFE: 20 - 100	5000	5
50115	TO-3		VCBO : 800 V T <sub>j</sub> : 150 °C IC : 15 A			
	NPN	Commutazione	Dati tecnici come BU115 eccetto:			
BU116	TO-3		VCER: 300 V VCBO: 400 V	·		
	NPN	Ampl. pilota	Dati tecnici come BU115 eccetto:			
BU117	TO-3	orizz. TV colore	V <sub>CER</sub> : 200 V V <sub>CBO</sub> : 250 V			
	NPN .	Chopper TV	VCEO : 250 V P : 50 W	hFE: 35 - 165	1000	5
BU120	TO-3		VCBO : 400 V T <sub>C</sub> : 75 °C IC : 5 A Tj : 150 °C	•1 . M MITZ		

SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MASS (T <sub>a</sub> = 25 °C)	IMI		TERISTICHE = 25 °C)	a (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	.f {MHz
	NPN	Ampl. finale	V <sub>CEO</sub> : 200 V	P : 50 mW		heE:>7	6000	5	
BU 121		orizz. TV	VCBO : 320 V	T <sub>C</sub> : 75 °C		f <sub>T</sub> : 6 MHz			
	TQ-3		I <sub>C</sub> : 10 A	T <sub>j</sub> : 150 °C					
	NPN	Ampl. finale	VCEO : 150 V	P : 50 W		hFE: 25 - 250	1000	5	
BU122		yert, TV	VCBO : 250 V	T <sub>C</sub> : 75 °C		iT : 10 MHz			
	TO-3		IC : 5 A	Tj : 150 °C				•	
	NPN	Ampl. finale BF	VCEO : 120 V	P : 50 W		hFE: 25 - 250	1000	5	
3U 123		alta tensione	VCBO : 180 V	T <sub>C</sub> : 75 °C		f <sub>T</sub> : 10 MH <sub>2</sub>			
	TO-3	Commutazione	IC : 5 A	Tj : 150 °C					
	NPN	Defless, orizz, TV	VCEO : 300 V	P : 30 W		f <sub>T</sub> : 8 MHz	200	10	
BU126			V <sub>CEX</sub> : 750 V	T <sub>C</sub> : 50 °C		•			
	TQ-3		IÇ : 3 A	Tj : 125 °C					
	NPN	Ampt, finale	VCEX : 400 V	P : 25 W		hpE:>20	3000	1,5	
BU129		orizz. TV	IÇ : 5 A	T <sub>C</sub> : 100 °C		fT : 10 MHz			
	TO-3		•	Tj : 150 °C		Ì			
	PNP	Impieghi	V <sub>CES</sub> 70 V	P : 0,15 W		β : 50 - 600	6	12	
SFT162		generali AF	VCBO : 70 V	T; : 100 °C		fT :>70 MHz	6	12	
	TO-1	alta tensione	IC : 10 mA	R <sub>thc</sub> : 300 °C/W					
	PNP	Preampl, video TV	VCEO : 16 V	P : 0,15 W		β : 200	4	9	
SFT163			V <sub>CBO</sub> : 32 V	T <sub>i</sub> : 100 °C		fT : 140 MHz	4	9	
	TO-1		Ic . : 10 mA	R <sub>the</sub> : 300 °C/W				_	
	PNP	Ampt. BF	VCER : 60 V	P : 45 W		hFE : >15	6000	1	
		di potenza	$(R_{BE}: 220 \Omega)$	Tc : 25 °C	Y	hFE: 30 - 70	2000	2	
SFT211			VCBO : 80 V	T <sub>j</sub> :95 °C	х	hFE: 50 - 100	2000	2	
			IC : 6 A			fβ : 8 kHz	500	14 14	
	TO-3					f <sub>T</sub> : 0,5 MHz	500	14	
	PNP	Ampl. BF	VCER: 40 V	P : 45 W		hFE:>20	3000	2	
		di potenza	(RBE : 220 Ω)	T <sub>C</sub> : 25 °C	Y	h¢g:30 - 70	2000	2	
SFT213			VCBO: 40 V	T <sub>j</sub> : 95 °C	х	hFE: 50 - 100	2000 1000	2 5	
	_		IC : 3 A			β :50 f <sub>β</sub> :8 kHz	500	14	
	TO - 3					ъ . о ки			
	PNP	Ampl. BF	VCBO : 60 V	P:45W		hFE:>15	3000		
		di potenza	IC : 3 A	T <sub>C</sub> : 25 °C	Z	hFE: 20 - 40	2000	2	
		Circuiti elim.		Tj:95 °C	Y	hfE: 30 - 70	2000	2	
SFT214					х	hFE: 50 - 100	2000	2	
						iβ : 8 kHz i <sub>T</sub> : 0,5 MHz	500 500	14 14	
	TQ - 3					T . 0,3 MI12			
SFT250	PNP			nici come SFT214 ecc	etto:				
	TO-3		VCBO : 80 V			_			
	PNP	Ampl. FI	VCEO : 16 V	P : 0,185 W T <sub>j</sub> : 100 °C		$\beta$ : 50 $y_{fe}$ : 17 - 21 mS	1	6 6	2
SFT306	TO-1	per AM	V <sub>CBO</sub> : 24 V Ic : 10 mA	R <sub>thc</sub> : 200 °C/W		fr: 5 MHz	1	6	
	PNP			nici come SFT308 eco	etto:	β : 75	1	6	
	FHE		mpreyo e uau tec	, come of 1000 too	bianco	y <sub>fe</sub> : 19 - 24 mS	1	6	2
SFT307					giatlo	v <sub>te</sub> : 22 - 28 m\$	1	6	2
	TQ-1				-	fr : 7 MHz	1	6	

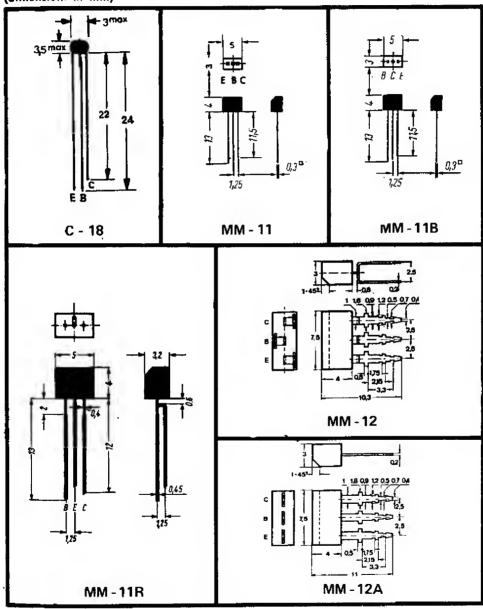
SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T <sub>a</sub> = 25 °C)	CARA {T	TTERISTICHE a	Ic (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	f (MHz
	PNP	Ampl. RF	Oati tecnici come SFT306 eccetto:		β : 100	1	. 6	
SFT308		conv. oscill. OM			Yfe: 26 - 30 mS	1	6	2
	TQ-1			giallo	y <sub>fe</sub> :>28 m\$ f <sub>T</sub> : 9 MHz	1	6 6	2
-	PNP	Ampl. FI	V <sub>CEO</sub> : 16 V P : 0,15 W	viola	β : 100	1	6	
		per AM - FM	V <sub>CBO</sub> : 32 V T <sub>i</sub> : 100 °C	blu	β : 150	1	6	
\$FT316		cony AM	IC : 10 mA R <sub>thc</sub> : 300 °C/W		y <sub>fe</sub> : 20 mS	1	6	50
	TO-72L				†† : 70 MHz	1	. 6	<u>-</u>
	PNP	Conv. AM	Dati tecnici come SFT316 eccetto:		β : 150	1	6	
SFT317					y <sub>fe</sub> : 15 mS	1	6	50
	TO-1				f <sub>T</sub> : 60 MHz	1	6	
SFT319 ·	PNP	Ampl, Fløer AM⊨	Dati tecnici come SFT316 eccetto	verde	β : 70	1	6	
3F1319	TO - 1			blu	β : 150 	1	6	
SFT320	PNP	Oscill, conv.	Dati tecnici come SFT316 eccetto		β : 150	1	6	
SF1320	TQ-1	per OM - OC			f <sub>T</sub> : 60 MHz	1	6	
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V P . 0,25 W		hFE: 20-40	100	1	
			VCBO : 32 V T <sub>j</sub> : 100 °C	oro	hpE : 25	100	1	
SFT321			I <sub>C</sub> : 0,3 A R <sub>thc</sub> : 80 °C/W	arańcio	hFE: 35	100	1	
					fβ : 17 kHz	1	6	
	TO - 1		•		f <sub>T</sub> : 0,8 MHz	1	6	
	PNP	Ampl. finale BF	V <sub>CEO</sub> : 20 V P : 0,28 W		hFE: 40-60	100	1	
			V <sub>CBO</sub> : 32 V T; : 100 °C	giallo	hFE: 45	100	1	
SFT322			IC : 0.3 A Rthc : '80 °C/W	verde	hpg : 55	100	1	
					fβ : 18 kHz	1	6	
	TO-1			_	f <sub>T</sub> : 1,2 MHz	1	6	
	PNP	Ampl, finale BF	VCEO : 20 V P : 0,25 V		heg.: 60 - 150	100	1	
		compl. SFT373	V <sub>CBO</sub> : 32 V T <sub>j</sub> : 100 °C	blu	hfE: 67	100	1	
SFT323			IC : 0,3 A R <sub>the</sub> : 80 °C/W	viola	hFE: 90	100	1	
311969				bianco	hpE:115 fβ:19 kHz	100 1	6	
	TO-1				fT : 2,4 MHz	i	6	
					β : 50 - 100	1	6	-
	PNP	Preampt. BF	VCEO : 16 V P : 0,185 W	V	β : 75 - 150	1	6	
OFT.		basso rumore	V <sub>CBO</sub> : 24 V T <sub>i</sub> : 100 °C I <sub>C</sub> : 0,15 A R <sub>the</sub> : 200 °C/W		β : 125 - 250	1	6	
SFT337			1C : 0,13 A 11me : 200 0/11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1β : 40 kHz	1	6	
	TO - 1				1 <sub>T</sub> : 7 MHz	1	6	
	PNP	Preampl, BF	Dati tecnici come SFT337 eccetto:		β : 45 - 160	1	6	
	1 +41	- Countype, DI		verde	β: 55	1	6	
SFT337A		•		blu	β : 70	1	6	
				viola	β : 90	1	6	
	TO-1			bianco	β : 130	1	6	
-	PNP	Ampl. BF	V <sub>CES</sub> : 70 V P: 0,25 W		β :>30	1	6	
		alta tensione	VC80 : 70 V T; : 100 °C	V		1	6	
SFT343			IC : 0,15 A Pthc : 80 °C/	W VI	$\beta$ :>75	1	6	
				•	tβ : 18 kHz	1	6	
	TO - 1				f <sub>T</sub> : 1,2 MHz	1	6	

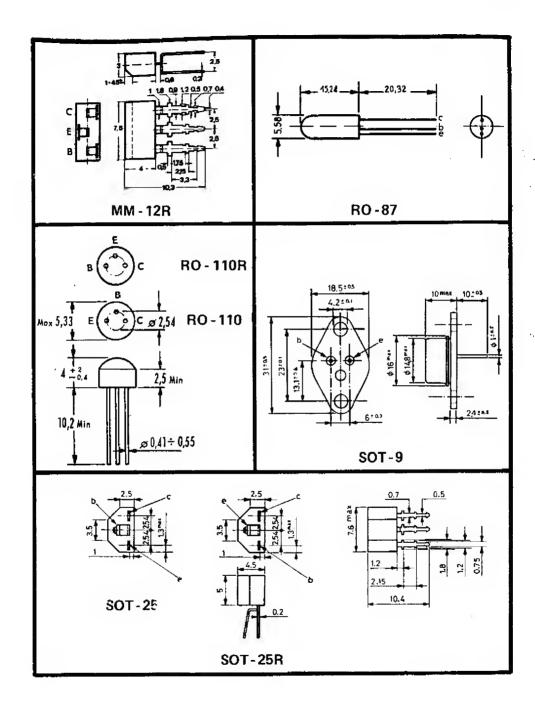
SIGLA	CONT.	IMPIEGO	VALORI MAS {T <sub>8</sub> = 25 °C			ATTERISTICHE T <sub>e</sub> = 25 °C)		V <sub>CE</sub> (V)	f (MH
	PNP	Preampl. e	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,25 W		β : 20 - 45	. ,	6	
		pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 32 V	Ti : 100 °C	oro	β : 27	1	6	
SFT351			IC : 0,15 A	R <sub>the</sub> : 100 °C/W	arancio	β:37	1	6	
						fg : 17 kHz	1	6	
	TO-1					f <sub>T</sub> : 0,8 MHz	1	6	
	PNP		Impiego e dati teo	cnicí come SFT351 ecci	etto:	β : 35-65	1		
					giallo	β : 45	1	6	
SFT352					verde	β : 55	1	6	
						fβ : 18 kHz	1	6	
	ŤO-1		_			f <sub>T</sub> ± 1,2 MHz	1	6	
	PNP	Preampl. e	V <sub>CEO</sub> : 20 V	P : 0,25 W		β : 55 - 250	1	6	
		pilota BF	V <sub>CBO</sub> : 32 V	Tj : 100 °C	blu	β : 70	1	6	
			IC : 0,15 A	R <sub>the</sub> : 100 °C/W	viola	$\beta$ : 90	1	6	
SFT353					bianco	$\beta$ : 125	1	6	
					grigio	$\beta$ : 195	1	6	
						fβ: 19 kHz	1	6	
	TO-1					f <sub>T</sub> : 2,4 MHz	1	6	
	PNP	Oscill, conv.	V <sub>CEO</sub> : 16 V	P : 0,15 W		β : 150	1	6	
SFT354		per OM - OC	V <sub>CBQ</sub> : 32 V	Tj : 100 °C		Yfe: 38 mS	1	6	0,5
	TO - 72L		IC : 10 mA	R <sub>thc</sub> : 300 °C/W		f <sub>T</sub> : 80 MHz	1	6	
	PNP	Oscill, conv.	V <sub>CEO</sub> : 16 V	P 0.15 W		β : 150	1	6	
SFT357		per MF	VCBO : 32 V	Ti : 100 °C		γ <sub>fh</sub> : 16 mS	1	6	100
	TO-72L		IC : 10 mA	R <sub>the</sub> : 300 °C/W		f <sub>T</sub> : 90 MHz	1	6	
	PNP	Preampl. RF	V <sub>CEO</sub> : 16 V	P : 0,15 W		β : 150	1	6	
SFT358		per MF	V <sub>CBO</sub> : 32 V	Tj : 100 °C		yfb 18 mS	1	6	100
	TO - 72L		IC : 10 mA	R <sub>thc</sub> : 300 °C/W		f <sub>T</sub> : 110 MHz	1	6	
	NPN	Ampl. finale BF	VCEO: 6 V	P : 0,25 W	v	hFE : 50-100	100	1	
		compl. SFT323	VCBO : 12 V	T; : 100 °C	VI	hpE : 75 - 150	100	1	
			IC : 0,3 A	R <sub>thc</sub> : 80 °C/W	VII	heE : 125 - 250	100	1	
SFT373					blu	hFE : 70	100	1	
					viola	hfE : 85	100	1	
					bianco	hFE : 130	100	1	
						fβ : 35 kHz	1	6	
	1-OT					f <sub>T</sub> : 3,5 MHz	1		
	NPN	Commutazione	V <sub>CEO</sub> : 25 V	P ; 0,3 W		hFE : 30-90	2	4.5	
SFT713			V <sub>CBO</sub> : 25 V	Tj : 175 °C		f† : 300 MHz	10	5	
	TO - 18		IC : 0,2 A	Rthc: 150 °C/W					

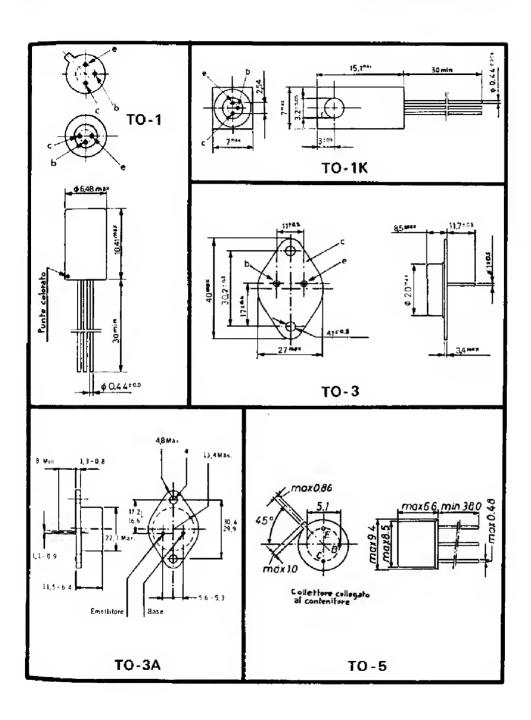
\* \* \* \* \*

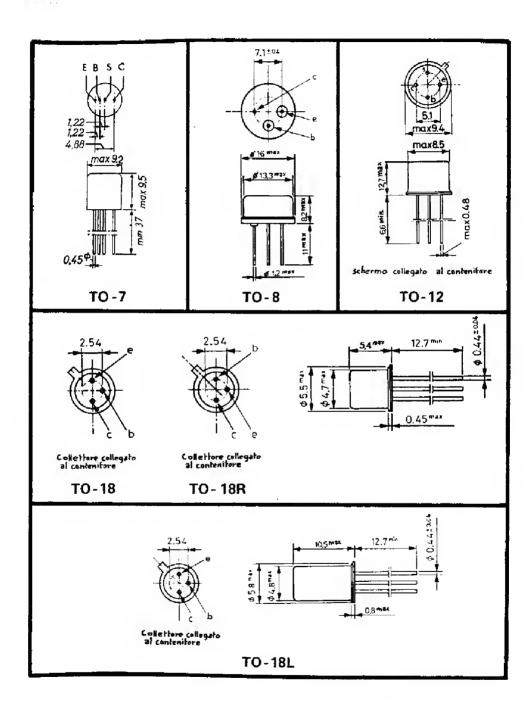
#### CONTENITORI

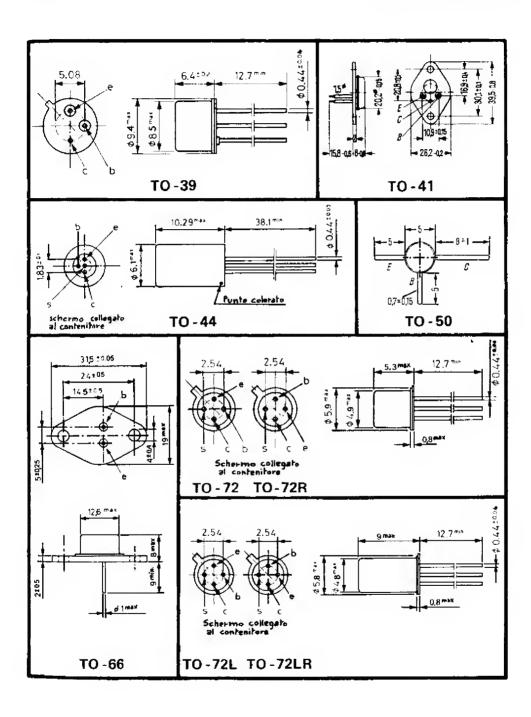
(dimensioni in mm)

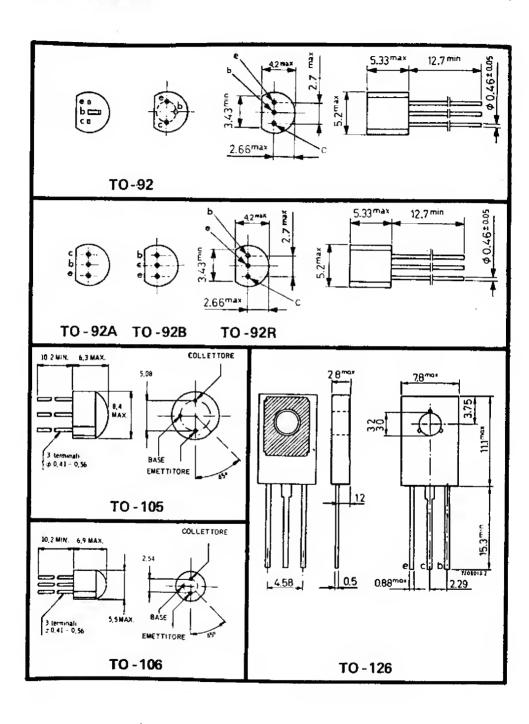


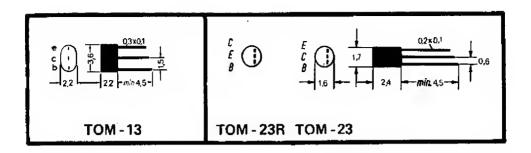






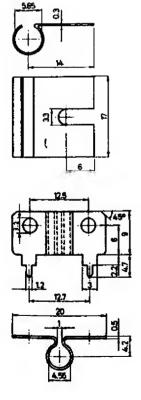






#### ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

(dimensioni in mm)



ALETTA Nº 1 (tipo Philips 56227)

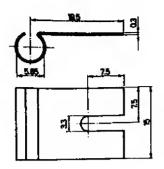
Resistenza termica R<sub>thd</sub> = 100 °C/W

Materiale: ottone placcato in nichel

ALETTA Nº 2 (tipo Philips 56263)

Resistenza termica R<sub>thd</sub> = 100 °C/W

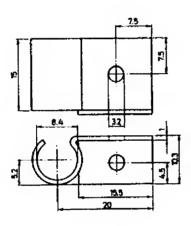
Materiale: rame placcato in stagno



# ALETTA Nº 3 (tipo Philips 56200)

Materiale: ottone placcato in nichel

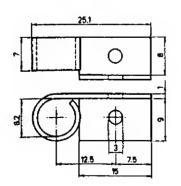
Resistenza termica R<sub>thd</sub> = 100 °C/W



## ALETTA Nº 4 (tipo Philips 56207)

Materiale: alluminio brunito

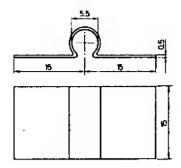
Resistenza termica Rthd = 60 °C/W



## ALETTA Nº 5 (tipo Philips 56265)

Materiale: alluminio brunito

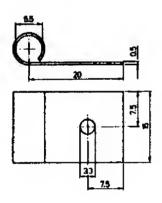
Resistenza termica Rthd = 80 °C/W



## ALETTA Nº 6 (tipo Philips 56209)

Materiale: ottone placcato in nichel

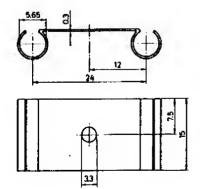
Resistenza termica Rthd = 75 °C/W



### ALETTA Nº 7 (tipo Philips 56210)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica R<sub>thd</sub> = 95 °C/W



ALETTA Nº 8 (tipo Philips 56208)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica R<sub>thd</sub> = 102 °C/W